Bibliographic Fields

Document Identity

(19)【発行国】
日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】
公開特許公報(A)
(11)【公開番号】
特開平10-130175
(43)【公開日】
平成10年(1998)5月19日
Public Availability

Public Availabilit

(43)【公開日】

平成10年(1998)5月19日

Technical

(54)【発明の名称】 エタン誘導体の製造方法

(51)【国際特許分類第6版】

C07B 35/02 B01J 31/24 C07C 45/62 47/02 49/04 51/36

57/34 67/303

69/14

209/68

211/27 231/12

233/46

// C07B 53/00

61/00 300 C07F 9/50

[FI]

(19) [Publication Office]

Japan Patent Office (JP)

(12) [Kind of Document]

Unexamined Patent Publication (A)

(11) [Publication Number of Unexamined Application]Japan Unexamined Patent Publication Hei 10- 130175(43) [Publication Date of Unexamined Application]

1998 (1998) May 19*

(43) [Publication Date of Unexamined Application]

1998 (1998) May 19*

(54) [Title of Invention]

manufacturing method of ethane derivative

(51) [International Patent Classification, 6th Edition]

C07B35/02 B01J31 /24

C07C45/62

47/02 49/04 51/36

57/34 67/303 69/14 209/68

211/03 211/27

231/12233/46

//C07B53/00 61/00300

C07F9/50

[FI]

Page 1 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

JP1998130175A

【識別番号】

000002093

C07B 35/02	C07B35/02	
B01J 31/24 Z	B01J31 /24Z	
C07C 45/62	C07C45/62	
47/02	47/02	
49/04 E	49/04E	
51/36	51/36	
57/34	57/34	
67/303	67/303	
69/14	69/14	
209/68	209/68	
211/03	211/03	
211/27	211/27	
231/12	231/12	
233/46	233/46	
C07B 53/00 B	C07B53/00B	
61/00 300	61/00300	
C07F 9/50	C07F9/50	
【請求項の数】	[Number of Claims]	
5	5	
【出願形態】	[Form of Application]	
OL	OL	
【全頁数】	[Number of Pages in Document]	
13	13	
Filing		
【審査請求】	[Request for Examination]	
未請求	Unrequested	
(21)【出願番号】	(21) [Application Number]	
特願平8-290086	Japan Patent Application Hei 8- 290086	
(22)【出願日】	(22) [Application Date]	
平成8年(1996)10月31日	1996 (1996) October 31 *	
Parties		
Applicants		
(71)【出願人】	(71) [Applicant]	
	er 1	

Page 2 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

000002093

[Identification Number]

1998-5-19

JP1998130175A [Name] 【氏名又は名称】 Sumitomo Chemical Co. Ltd. (DB 69-053-5307) 住友化学工業株式会社 [Address] 【住所又は居所】 Osaka Prefecture Osaka City Chuo-ku Kitahama 4-5-33 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 Inventors (72) [Inventor] (72)【発明者】 [Name] 【氏名】 Tamao Akira * 玉尾 皓平 [Address] 【住所又は居所】 Kyoto City Kamigyo-ku Kawahara-doori Marutamachi *jp 京都市上京区河原町通丸太町上ル出水町(番 11 Demizu-cho (no address) 地なし) (72) [Inventor] (72)【発明者】 [Name] 【氏名】 Saito ** 斎藤 清機 [Address] 【住所又は居所】 Okayama City Tsushima Fukui 1-Chome 8*63- 5 岡山市津島福居1丁目8番63-5 (72) [Inventor] (72)【発明者】 [Name] 【氏名】 Yamaguchi Shigehiro 山口 茂弘 [Address] 【住所又は居所】 Kyoto Prefecture Uji City Gokasho Nishinoura 16 京都府宇治市五ケ庄西浦16 (72) [Inventor] (72)【発明者】 [Name] 【氏名】 Yanagawa Masao 柳川 正生 [Address] 【住所又は居所】 Osaka Prefecture Takatsuki City Tsukahara 2-10 1*Sumit 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学 omo Chemical Co. Ltd. (DB 69-053-5307) * 工業株式会社内 (72) [Inventor] (72)【発明者】 [Name] 【氏名】 Oda Yoshiaki 織田 佳明 [Address] 【住所又は居所】 Osaka Prefecture Takatsuki City Tsukahara 2-10 1*Sumit 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学 omo Chemical Co. Ltd. (DB 69-053-5307) *

Page 3 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

[Patent Attorney]

(74) [Attorney(s) Representing All Applicants]

工業株式会社内

(74)【代理人】

【弁理士】

Agents

JP1998130175A

【氏名又は名称】

久保山 隆(外1名)

Abstract

(57)【要約】

【課題】

転化率、選択性に優れたエタン誘導体の製造 方法を提供する。

【解決手段】

[Name]

Kuboyama Takashi (1 other)

(57) [Abstract]

[Problems to be Solved by the Invention]

manufacturing method of ethane derivative which is supe rior in conversion ratio, selectivity is offered.

[Means to Solve the Problems]

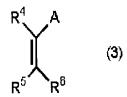
is shown, general formula (3)

一般式(1)				
General Formula (1)	*			
[MYpZ]qXr (1)				
{MYpZ } qXr (1)	•			
〔式中、Mは遷移金属原子を示し	Zlå	般式(2)
<seq>In Formula, as for M transition metal atom showing</seq>	As for Z	<seq>General system</seq>	2)
で示される光学活性 3 級ホスフィン化合物を示 So optical	activity ternie	ry phosphine compound w	hich	is

で示される光学活性 3 級ホスフィン化合物を示 す。

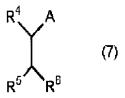
]で示される遷移金属錯体の存在下に、一般式

shown is shown.) With under existing of transition metal complex which



(3)

で示されるオレフィン化合物と水素とを反応させ ることを特徴とする一般式(7)



で示されるエタン誘導体の製造方法。

So olefin compound and hydrogen which are shown gene ral formula which designates that it reacts as feature (7)

So manufacturing method . of ethane derivative which is shown

Claims

【特許請求の範囲】

[Claim (s)]

【請求項1】

[Claim 1]

	一般式(1)		
	General Formula (1)	General Formula (1)	
[MYpZ]	qXr	(1)	
{MYpZ }	qXr	(1)	

$$(R^{1})_{n}(R^{2})_{3-n}SiO$$

$$P(R^{3})_{2}$$

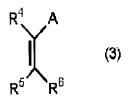
$$(R^{1})_{n}(R^{2})_{3-n}SiO$$

$$P(R^{3})_{2}$$
(2)

3 級アミンを示し、Y は鎖状もしくは環状のジエン 化合物を示し、Z は一般式(2)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ独立に鎖状もしくは環状の低級アルキル基またはハロゲン原子もしくは低級アルキル基もしくは低級アルコキシ基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^3 の整数を示す。)で示される 3 級ホスフィン化合物を示し、 R^3 は 1 または 2、 R^3 は 1 または 2 をそれぞれ示す。

]で示される遷移金属錯体の存在下に、一般式 (3)



{式中、R⁴、R⁵、R⁶ はそれぞれ単独に水素原子、低級アルコキシル基もしくはヒドロキシ基もしくはカルボキシル基もしくはアルコキシカルボニル基もしくはアルキルカルボニル基もしくはアルロゲン原子で置換されていてもよい鎖状もしくは環状の低級アルキル基もしくはに級アルキル基もしくはヒドロキシ基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよいアリール基またはアラルキル基またはカルボキシル基を示す。ただし、R⁵と R⁶とが同一であることはない。 A は一般式(4)-COX (4) [式中、X は水素原子、低級アルキル基、ヒドロ

To show tertiary amine, Y to show diene compound of chain or the cyclic, as for Z General Formula (2)

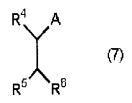
terniery phosphine compound which is shown with (In F ormula, R¹, R², R³ in respective independence shows optionally substitutable phenyl group with lower alkyl group or phenyl group h alogen atom or alkoxy group lower alkyl group or lower alkoxy group of chain or cyclic, n shows integer 0 - 3.) is shown, as for p as for 0 or 1, q as for 1 or 2, r 1 or 2 is shown respectively.

) With under existing of transition metal complex which is shown, general formula (3)

olefin compound and hydrogen which are shown with {I n Formula, R⁴, R⁵, R⁶ in respective alone with hydrogen atom, lower alko xy group or the hydroxyl group or carboxyl group or al koxycarbonyl amino acid basis or alkyl carbonyl group or a mide group or the halogen atom shows optionally sub stitutable aryl group or aralkyl group jp11 kill basis or c arboxyl group with lower alkyl group, lower alkoxyl or alkyl ester group lower alkyl group or hydroxyl group or halogen atom of optionally substitutable chain or cyclic. However, there are not times when R⁵ and R⁶ are thesame. A general formula (4) -

Page 5 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

キシ基、低級アルコキシル基または一般式(5)- NR^7R^8 (5)(式中、 R^7 、 R^8 はそれぞれ独立に水素原子または低級アルキル基を示し、 R^7 と R^8 とが結合して N 原子とともに環を形成していてもよい。)で示される置換基を示す。]で示される置換基をまたは一般式(6)- NR^9R^{10} (6)(式中、 R^9 、 R^{10} はそれぞれ単独で水素原子、低級アルキル基、アリール基またはアシル基を示す。)で示される置換基を示す。}で示されるオレフィン化合物と水素とを反応させることを特徴とする一般式(7)



(式中、A、R⁴、R⁵、R⁶ は前記と同じ意味を表す。)で示されるエタン誘導体の製造方法。

【請求項2】

一般式(3)で示されるオレフィン化合物における R⁴ がカルボキシル基もしくはアルコキシカルボニル基もしくはアミド基で置換された低級アルキル基であることを特徴とする請求項 I に記載の 製造方法。

【請求項3】

一般式(3)で示されるオレフィン化合物における R⁴ がカルボキシル基もしくはアルコキシカルボニル基で置換された低級アルキル基であることを特徴とする請求項 I に記載の製造方法。

【請求項4】

一般式(2)で示されるホスフィン化合物がその光 学活性体であることを特徴とする請求項 1 に記 載の製造方法。

【請求項5】

遷移金属錯体の使用量がオレフィン化合物に対して 0.000001~0.5 モル倍であることを特徴とする請求項1に記載の製造方法。

COX substituent or general formula which is shownwith (4) {In Formula, X hydrogen atom, lower alkyl group, hydroxyl group, lower alkoxy group or acyloxy group general formula (5) -NR⁷R⁸ sho ws substituent which isshown with (5) (In Formula, R<s up>7</sup>, R⁸ hydrogen atom or lower alk yl group jp11 kill basis is shown in respective independen ce, R⁷ and R⁸ connect and with Natom are possible to form ring.). } (6) -NR⁹ R¹⁰ shows substituent which is shown with (6)(In Formula, R⁹, R¹⁰ show s hydrogen atom, lower alkyl group, aryl group or acy l group jp11 basis with respective alone.). } general formula which designates that it reacts as feature (7)

manufacturing method . of ethane derivative which is shown with (In Formula, A, R<sup>4<sup>, R⁵0, R⁶0 displays same meaning as descriptiona bove.)

[Claim 2]

manufacturing method . which is stated in Claim 1 which designates that R⁴ in olefin compound which is shown with general formula (3) is carboxyl group or alkoxycarbonylation reaction basis or lower alkyl group which is substituted with amide group as feature

[Claim 3]

manufacturing method . which it states in Claim 1 which designates that it is a lower alkyl group where R⁴ in olefin compound being shown with general f ormula (3) issubstituted with carboxyl group or alkoxycar bonyl amino acid basis as feature

[Claim 4]

manufacturing method, which is stated in Claim 1 which designates that phosphine compound which is shown with General Formula (2) is optical isomer as feature

[Claim 5]

amount used of transition metal complex manufacturing method . which is stated in Claim 1 which designates tha t they are 0.000001 - 0.5 molar multiple vis-a-vis ole fin compound asfeature

JP1998130175A

Specification

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、エタン誘導体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

発明者らはすでに、新規な 3 級ホスフィン化合物を開発し、この3級ホスフィン化合物の遷移金属錯体を触媒とした分子内不斉ヒドロシリル化において優れた転化率、選択性を発現することを見い出している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、かかる新規な3級ホスフィン化合物の遷移金属錯体を、オレフィン化合物の水素化反応における触媒として適用した例はなく、この遷移金属錯体が優れた選択性、転化率を発現するかについては全く知られていなかった。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、新規な 3 級ホスフィン化合物の 遷移金属錯体は、その存在下においてオレフィン化合物と水素とを反応させてエタン誘導体を 製造する際に、転化率、選択性に優れ、かつ優れた触媒活性を発現することを見い出し、本発明に至った。

[0005]

[Description of the Invention]

[0001]

[Technological Field of Invention]

this invention regards manufacturing method of ethane de rivative .

[0002]

[Prior Art]

inventors already develops novel terniery phosphine compound, discovers fact that the conversion ratio, selectivity which is superior in intramolecular asymmetric hydrosily lation which designates transition metal complex of the this terniery phosphine compound as catalyst is revealed.

[0003]

[Problems to be Solved by the Invention]

But, concerning whether there is not an example which i t applies as catalyst in transition metal complex of this n ovel terniery phosphine compound, hydrogenation of ole fin compound itreveals selectivity, conversion ratio where this transition metal complex is superior * it was not knowncompletely.

[0004]

[Means to Solve the Problems]

As for these inventors, as for transition metal complex of novel terniery phosphine compound, olefin compound and the hydrogen reacting in under existing, when producing ethane derivative, it wassuperior in conversion ratio, selectivity, discovering fact that catalytic activity which atsame time is superior is revealed, it reached to this invention.

[0005]

	すなわち本発明は、一般式(1)		
	Namely as for this invention, General Formula (1)		
[MYpZ]	qXr	(1)	
{MYpZ }	qXr	(1)	

3級アミンを示し、Yは鎖状もしくは環状のジエン 化合物を示し、Zは一般式(2) To show tertiary amine, Y to show diene compound of chain or the cyclic, as for Z General Formula (2)

$$(R^{1})_{n}(R^{2})_{3-n}SiO$$
 $P(R^{3})_{2}$
 $(R^{1})_{n}(R^{2})_{3-n}SiO$
 $P(R^{3})_{2}$
(2)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ独立に鎖状もしくは環状の低級アルキル基またはハロゲン原子もしくは低級アルキル基もしくは低級アルコキシ基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^3 の整数を示す。)で示される 3 級ホスフィン化合物を示し、 R^3 は 1 または 2、 R^3 は 1 または 2 をそれぞれ示す。

]で示される遷移金属錯体の存在下に、一般式(3)

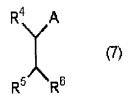
$$\begin{array}{ccc}
R^4 & A \\
R^5 & R^6
\end{array}$$
(3)

{式中、R⁴、R⁵、R6はそれぞれ単独に水素原 子、低級アルコキシル基もしくはヒドロキシ基も しくはカルボキシル基もしくはアルコキシカルボ ニル基もしくはアルキルカルボニル基もしくはア ミド基もしくはハロゲン原子で置換されていても よい鎖状もしくは環状の低級アルキル基、低級 アルコキシ基もしくは低級アルキル基もしくはヒ ドロキシ基もしくはハロゲン原子で置換されてい てもよいアリール基またはアラルキル基または カルボキシル基を示す。ただし、R⁵と R⁶とが同 ーであることはない。A は一般式(4)-COX (4) 〔式中、X は水素原子、低級アルキル基、ヒドロ キシ基、低級アルコキシル基または一般式(5)-NR⁷R⁸ (5)(式中、R⁷、R⁸ はそれぞれ独立に水素 原子または低級アルキル基を示し、R7とR8とが 結合して N 原子とともに環を形成していてもよ い。)で示される置換基を示す。]で示される置換 基または一般式(6)-NR⁹R¹⁰ (6)(式中、R⁹、R¹⁰ はそれぞれ単独で水素原子、低級アルキル基、 アリール基またはアシル基を示す。)で示される 置換基を示す。}で示されるオレフィン化合物と 水素とを反応させることを特徴とする一般式(7)

terniery phosphine compound which is shown with (In F ormula, R¹, R², R³ in respective independence shows optionally substitutable phenyl group with lower alkyl group or phenyl group h alogen atom or alkoxy group lower alkyl group or lower alkoxy group of chain or cyclic , n shows integer 0 - 3.) is shown, as for p as for0 or 1 , q as for 1 or 2 , r 1 or 2 is shown respectively.

) With under existing of transition metal complex which is shown, general formula (3)

olefin compound and hydrogen which are shown with {I n Formula, R⁴, R⁵, R^{6</s up> in respective alone with hydrogen atom, lower alko xy group or the hydroxyl group or carboxyl group or al koxycarbonyl amino acid basis or alkyl carbonyl group o r amide group or the halogen atom shows optionally sub stitutable aryl group or aralkyl group jp11 kill basis or c arboxyl group with lower alkyl group, lower alkoxyl or alkyl ester group lower alkyl group or hydroxyl group or halogen atom of optionally substitutable chain or cycli c. However, there are not times when R⁵ a nd R⁶ are thesame. A general formula (4) -COX substituent or general formula which is shownwith (4) {In Formula, X hydrogen atom, lower alkyl group, hydroxyl group, lower alkoxy group or acyloxy group general formula (5) -NR⁷R⁸ sho ws substituent which isshown with (5) (In Formula, R<s up>7}, R⁸ hydrogen atom or lower alk yl group jp11 kill basis is shown in respectiveindependen ce. R⁷ and R⁸ connect and with Natom are possible to form ring.). } (6) -NR<sup>9</su p>R¹⁰ shows substituent which is shown wit h (6)(In Formula, R⁹, R¹⁰ show s hydrogen atom, lower alkyl group, aryl group or acy I group ip11 basis with respective alone .). } general fo rmula whichdesignates that it reacts as feature (7)



(式中、A、 R^4 、 R^5 、 R^6 は前記と同じ意味を表す。)で示されるエタン誘導体の製造方法を提供するものである。

[0006]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明において用いられる一般式(1)で示される遷移金属錯体において M で示される遷移金属としては、例えばロジウム、ルテニウム、イリジウムまたはパラジウムなどが挙げられる。

[0007]

また、X として具体的には CI^- 、 CIO_4^- 、 BF_4^- 、 PF_6^- 、 PCI_6^- 、 SbF_6^- または CH_3COO^- などの 1 価のアニオンまたはトリエチルアミンなどのトリアルキルアミンなどの 3 級アミンが挙げられる。

かかるジエン化合物の遷移金属錯体において r で示される配位数は 1 または 2 である。

[0008]

Y で示される鎖状または環状のジエン化合物として具体的には 1,3-ブタジエン、1,5-ヘキサジエン、シクロペンタジエン、1,3-シクロヘキサジエン、ノルボルナジエンまたは 1,5-シクロオクタジエンなどが例示され、その配位数pは0または1である。

遷移金属錯体において q で示される配位数は 1 または 2 である。

[0009]

本発明において用いられる遷移金属錯体における一般式(2)で示される光学活性 3 級ホスフィン化合物において、 R^1 、 R^2 、 R^3 で示される鎖状もしくは環状の低級アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、4ソプロピル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル基、1-ブチル

It is something which offers manufacturing method of et hane derivative which is shownwith (In Formula, A, R<s up>4</sup>, R⁵, R⁶ displays sa me meaning as descriptionabove.).

[0006]

[Embodiment of the Invention]

Below, this invention is explained in detail.

Regarding to this invention, you can list for example rho dium, ruthenium, iridium or palladium etc as the transition metal which is shown with M in transition metal complex which is shown with General Formula (1) which is used.

[0007]

In addition, concretely you can list Cl^[], C IO₄^[], BF₄^[], PF₆^[], PCl₆^[], PCl₆^[] or anion or triethylamine or other trialkyl amine or other tertiary amine of the CH₃COO^[] or other monovalent as X.

coordination number which is shown with r in transition metal complex of this diene compound is 1 or 2.

[8000]

Concretely 1 and 3 -butadiene, 1, 5-hexadiene, cyclope ntadiene, 1, 3- cyclohexadiene, norbornadiene or 1 and 5 -cyclooctadiene etc are illustrated as the diene compo und of linear or cyclic which is shown with Y, coordina tion number p is 0 or 1.

coordination number which is shown with q in transition metal complex is 1 or 2 .

[0009]

Regarding to this invention, you can list for example me thyl group , ethyl group , n- propyl group , isopropyl gr oup , n- butyl group , isobutyl group , s-butyl group , t-butyl group , cyclohexyl group etc as lower alkyl group of the chain or cyclic which are shown with R<sup>1
/sup>, R², R³ in optical activity terniery phosphine compound whichis shown with Gener

る。

[0010]

フェニル基はフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子、上記と同様の低級アルキル基、メトキシ基、エトキシ基、n-プトキシ基、イソプロポキシ基、tert-ブトキシ基などの低級アルコキシ基で置換されていてもよい。

かかる置換基で置換されたフェニル基としては、例えば 2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフロフェニル基、3-クロロフェニル基、3-クロロフェニル基、2,4-ジクロロフェニル基、2-メトキシフェニル基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフェニル基、2,4-ジメトキシフェニル基、2,4,6-トリメトキシフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、3-トリル基、4-トリル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニル基をがそれぞれ挙げられる。

nは 0~3 の整数である。

[0011]

一般式(2)で示される 3 級ホスフィン化合物には 2 種類の光学活性体、すなわち(+)体と(-)体とが 存在するが、本発明の方法に用いる遷移金属 錯体においてかかる 3 級ホスフィン化合物はいずれの光学活性体であってもよいし、それらを任意の割合で含む物、例えばラセミ体であってもよい。

[0012]

かかる光学活性 3 級ホスフィン化合物はいずれも、例えば一般式(8)

HO
$$P(R^3)_2$$
 (8)

(式中、R3は前記と同じ意味を示す。)で示される ホスフィン化合物を塩基の存在下にシリル化剤 と反応させる方法により容易に製造することが できる。

[0013]

シリル化剤としては、例えば塩化トリメチルシリル、塩化 tert-ブチルジメチルシリル、塩化

al Formula (2) in transition metal complex which is use

[0010]

As for phenyl group with lower alkyl group, methoxy group, ethoxy group, n- propoxy group, isopropoxy group, n- butoxy group, isobutoxy group, s-butoxy group p, t- butoxy group or other lower alkoxy group which is similar to fluorine atom, chlorine atom, bromine atom, iodine atom or other halogen atom, descriptionabove optionally substitutable.

You can list for example 2- fluorophenyl group, 3- fluo rophenyl group, 4- fluorophenyl group, 2, 4- difluoro phenyl group, 2, 4, 6-trifluoro phenyl group, 2- chlorophenyl group, 3- chlorophenyl group, 4- chlorophenyl group, 2, 4- dichlorophenyl group, 2, 4, 6-trichlorophenyl group, 2- methoxyphenyl group, 3- methoxyphenyl group, 3- methoxyphenyl group, 4- dimethoxy phenyl group, 2, 4- dimethoxy phenyl group, 3- tolyl group, 4- tolyl group, 2, 4- dimethylphenyl group, 2, 4, 6-trimethyl group, 2, 4- dimethylphenyl group, 2, 4, 6-trimethyl phenyl group etc respectively as phenyl group which issubstituted with this substituent.

n is integer 0 - 3.

[0011]

optical isomer, namely (+) body and (-) body of 2 kind s exist in the terniery phosphine compound which is sho wn with General Formula (2), but terniery phosphine compound which catches in transition metal complex which is used for method of this invention is good any optical isomer and, it is good even with thing and for example racemate which include thoseat ratio of option.

[0012]

As for this optical activity terniery phosphine compound which, for example General Formula (8)

phosphine compound which is shown with (In Formula, R < sup > 3 < / sup > shows same meaning as description abov e.) can be produced easily with the method which react s with silylation under existing of base .

[0013]

As silylation, you can list for example chloride trimethy lsilyl, chloride t- butyl dimethyl silyl, chloride tri isopr

ソプロピルシリル、塩化トリフェニルシリル、臭化トリメチルシリル、臭化 tert-ブチルジメチルシリル、臭化トリイソプロピルシリル、臭化トリフェニルシリル、ヨウ化トリメチルシリル、ヨウ化 tert-ブチルジメチルシリル、ヨウ化トリフェニルシリル、トリフルオロメタンスルホン酸 t-ブチルジメチルシリル、トリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリル、トリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリル、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルなどが当フルオロメタンスルホン酸トリフェニルなどが当て通常 2~10 モル倍、好ましくは 3~5 モル倍必要である。

[0014]

塩基としては、有機塩基、無機塩基どちらも用 いることができる。

有機塩基としては、例えば、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ピコリン、1-メチルイミダゾール、N,N-ジメチルアニリン、ピリジン等が挙げられる。

無機塩基として具体的には、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等が 挙げられる。

その使用量はホスフィン化合物に対し通常 2~10 モル倍、好ましくは 3~5 モル倍である。

[0015]

反応に際して通常は溶媒が用いられ、かかる溶媒としては例えば、ヘキサンなどの炭化水素類、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素類、テトラヒドロフランなどのエーテル類などが用いられ、その使用量はホスフィン化合物に対して通常 2~20 重量倍である。

[0016]

反応は、例えば溶媒中でホスフィン化合物、塩 基およびシリル化剤を混合することにより行われ、反応温度は通常 0 deg $C \sim 100$ deg C、好 ましくは 20 deg $C \sim 50$ deg C の範囲である。

反応終了後、濃縮、抽出、シリカゲルカラム精製等の通常の後処理操作により目的のい 3 級ホスフィン化合物を得ることができる。

[0017]

かくして得られる3級ホスフィン化合物としては、 例えば2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン、2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ) opyl silyl , chlorinated triphenyl silyl , bromide trimethyl silyl , bromide t- butyl dimethyl silyl , bromide tri isopr opyl silyl , bromide triphenyl silyl , iodide trimethylsilyl , iodide t- butyl dimethyl silyl , iodide tri isopropyl sil yl , iodide triphenyl silyl , silver trifluoromethane sulfona te jpll Hong acid trimethylsilyl , silver trifluoromethane sulfonate jpll Hong acid tributyl dimethyl silyl , silver trifluoromethane sulfonate jpll Hong acid tri isopropyl sil yl , silver trifluoromethane sulfonate jpll Hong acid triphenyl etc, amount used usually 2 - 10 is molar multiple , preferably 3~5molar multiple necessary vis-a-vis phosp hine compound .

[0014]

As base, you can use organic base, inorganic base bot h

As organic base, you can list for example triethylamine, tributyl amine, diisopropyl ethylamine, picoline, 1-methyl imidazole, N, N- dimethyl aniline, pyridine etc.

Concretely, you can list sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydrogen carbonate, potassium hydrogen carbonate, sodium carbonate, potassium carbonate etc as inorganic base.

amount used is usually 2 - 10 molar multiple, preferably 3~5molar multiple vis-a-vis phosphine compound.

[0015]

It can use solvent usually at time of reaction, it can use the for example hexane or other hydrocarbons, dichlor omethane or other halogenated hydrocarbons, tetrahydrof uran or other ethers etc as this solvent, amount used is usually 2 - 20 weight multiple vis-a-vis phosphine compound.

[0016]

Reaction is done by mixing phosphine compound , base and silylation in for example solvent , the reaction temperature is range of usually 0 deg $C\sim100$ deg C, preferably 20deg $C\sim50$ deg C.

objective it is after reaction termination, with concentrat ion and, extractionand silica gel column purification or o ther conventional post-treatment can acquire termiery phosphine compound.

[0017]

As terniery phosphine compound which is acquired in thi s way, for example 2, 3- bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4-bis (diphenylphosphino) butane , 2, 3- bis (t- butyl d imethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) but

ブタン、2,3-ビス(トリイソプロピルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン、2,3-ビス(トリフ ェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ) ブタン、2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジ シクロヘキシルホスフィノ)ブタン、2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジシクロヘキ シルホスフィノ)ブタン、2,3-ビス(トリイソプロピル シロキシ)-1,4-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ) ブタン、2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス (ジシクロヘキシルホスフィノ)ブタン、2,3-ビス(ト リメチルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-メチルフェニル) ホスフィノ} ブタン、2,3-ビス(tert-ブチルジメチル シロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-メチルフェニル)ホスフィ ノ}ブタン、2,3-ビス(トリイソプロピルシロキシ)-1, 4-ビス{ジ(4-メチルフェニル)ホスフィノ}ブタン、2, 3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-メチ ルフェニル)ホスフィノ}ブタン、2,3-ビス(トリメチ ルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-フルオロフェニル)ホ スフィノ}ブタン、2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシ ロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-フルオロフェニル)ホスフィ ノ}ブタン、2,3-ビス(トリイソプロピルシロキシ)-1, 4-ビス{ジ(4-フルオロフェニル)ホスフィノ}ブタ ン、2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4 -フルオロフェニル)ホスフィノ}ブタンなどが挙げ られる。

[0018]

上記のおいて原料化合物として用いられるホスフィン化合物は、例えば J.Chem.Soc.,Chem.Commum.,481(1971)に記載の DIOP の製造方法に準じて酒石酸から容易に合成し得る一般式(9)

$$P(R^3)_2$$
 (9)

(式中、R³ は前記と同じ意味を示す。)で示される DIOP 類縁体を p-トルエンスルホン酸存在下、9 5%エタノール中で加熱還流させる方法により、 容易に製造することができる。

[0019]

本発明の遷移金属錯体は上記のようなものであるが、かかる遷移金属錯体は、例えば[RhCl(1,5-へキサジエン)] $_2$ [RhCl(1,5-シクロオクタジエン)] $_2$ [RhCl(ノルボルナジエン)] $_2$ 、[RuCl $_2$ (1,5-シクロオクタジエン)] $_n$ 、[IrCl(シクロオクテン) $_2$] $_2$ 、PdCl

ane, 2, 3- bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4-bis (dip henylphosphino) butane , 2, 3- bis (triphenyl siloxy) -1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane, 2, 3- bis (tri methyl siloxy) - 1 and 4-bis (dicyclohexyl phosphino) butane, 2, 3- bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (dicyclohexyl phosphino) butane , 2, 3- bis (tri iso propyl siloxy) - 1 and 4-bis (dicyclohexyl phosphino) butane, 2, 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis (dic yclohexyl phosphino) butane , 2, 3- bis (trimethyl silox y) - 1, 4 -bis {di (4 -methylphenyl) phosphino } buta ne, 2, 3- bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -methylphenyl) phosphino} butane, 2, 3- bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4-bis {di (4 -methylphenyl) phosphino } butane , 2, 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -methylphenyl) phosphino } butane, 2, 3- bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4-bis {di (4 -fluor ophenyl) phosphino } butane, 2, 3- bis (t- butyl dimet hyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -fluorophenyl) phosp hino } butane , 2, 3- bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4-bis {di (4 -fluorophenyl) phosphino } butane , 2, 3bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis you can list {di (4 -fluorophenyl) phosphino } butane etc.

[8100]

Description above putting, as for phosphine compound which is used as the starting material compound, for example Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (ISSN 0300-9246, CODEN JCDTBI). general formula which it can synthesize easily from tartaric acid, according to manufacturing method of DIOP which is stated in the Chemical Communications m., 481 (1971) (9)

It can produce easily DIOPanalog which is shown with (In Formula, R³ shows same meaning as description above.) with the method which heating and refluxing is done under ethyl p-toluenesulfonate acid existing and in 95% ethanol.

[0019]

transition metal complex of this invention as description above is thing, but this transition metal complex can pro duce for example [RhCl (1 and 5 -hexadiene)] ₂ [RhCl (1 and 5 -cyclooctadiene)] ₂ [RhCl (norbornadiene)] ₂, [RuCl<sub>2</s

2(ベンゾニトリル)2などの遷移金属化合物および3級ホスフィン化合物を反応させる方法によって容易に製造することができる。

[0020]

本発明に係る遷移金属錯体のうち、例えば M がロジウムに相当するロジウム錯体を製造する方法の例としては、特開昭 59-20294 号公報に記載の方法に従い、 μ -ジクロロビス(1,5-ヘキサジエン) $_2$ ロジウムおよび 3 級ホスフィン化合物を反応させて製造することができる。

製造したロジウム錯体は、濃縮等の操作により 単離した後、本発明の方法に用いることができ る。

また、予め反応系内で製造したのち取り出すことなく、用いることもできる。

[0021]

さらに、他の遷移金属錯体は、例えば以下の公知文献に準じて製造することができる。

ub> (1 and 5 -cyclooctadiene)] _n, [IrCl (c yclooctene) ₂]₂, PdCl₂ > transition meta 1 compound and terniery phosphine compound easily with method which reacts.

[0020]

The;mu -dichloro bis reacting, it can produce (1 and 5 -hexadiene) ₂rhodium and terniery phosphine compound inaccordance with method which is stated in Japan Unexamined Patent Publication Showa 59-20294dis closure among transition metal complex which relate to this invention, as example of method which produces the rhodium complex where for example M is suitable to rhodium.

After isolating with concentration or other operation, you can use the rhodium complex which it produces, for m ethod of this invention.

In addition, after producing beforehand inside reaction sy stem, it ispossible also to use without removing.

[0021]

Furthermore, it can produce other transition metal comple \boldsymbol{x} , according to public knowledge literature below for example .

J.Am.Chem.Soc.,2397,93,2397(1971)

Journal of the American Chemical Society (0002 - 7863, JACSAT) Soc., 2397, 93, 2397 (1971)

J.Chem.Soc.Chem.Commun.,922(1985)

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (ISSN 0300-9246, CODEN JCDTBI). Chemical Communications n., 922 (1985)

特開昭61-63690号公報

Japan Unexamined Patent Publication Showa 61- 63690disclosure

機金属錯体、1991年、丸善

[0022]

かかる遷移金属錯体としては、例えば RhCl(1,5 - ヘキサジエン)[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4 - ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]、RhCl(ノルボルナジエン)[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]、RhCl(1,5-シクロオクタジエン)[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]、[Rh(1,5-シクロオクタジエン)[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]ClO4、[Rh

Machine metal complex, 1991, Maruzen

[0022]

As this transition metal complex , for example RhCl (1 and 5 -hexadiene) {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane }, RhCl (norbor nadiene) {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane }, RhCl (1 and 5 -cycloo ctadiene) {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane }, [Rh (1 and 5 -cyclooct adiene) {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane } ClO₄, [Rh

(1,5-シクロオクタジエン)[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]]SbF $_{6}$ 、[Rh(1,5-シクロオクタジエン)[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]]BF $_{4}$ 、[RuCl $_{2}$ [2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]] $_{2}$ (N(C $_{2}$ H $_{5}$) $_{3}$)、Ru(O $_{2}$ CCH $_{3}$) $_{2}$ [2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]、IrCl[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]、[Ir(1,5-シクロオクタジエン)[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]]PF $_{6}$ 、PdCl $_{2}$ [2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]]PF $_{6}$ 、PdCl $_{2}$ [2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン]]

[0023]

および上記各化合物における[2,3-ビス(トリメチ ルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタ ン]が、[2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン〕、〔2,3-ビス (トリイソプロピルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニル ホスフィノ)ブタン]、[2,3-ビス(トリフェニルシロキ シ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン〕、〔2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジシクロヘキ シルホスフィノ)ブタン]、[2,3-ビス(tert-ブチルジ メチルシロキシ)-1,4-ビス(ジシクロヘキシルホス フィノ)ブタン〕、〔2,3-ビス(トリイソプロピルシロキ シ)-1,4-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)ブタ ン]、[2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジ シクロヘキシルホスフィノ)ブタン〕、〔2,3-ビス(トリ メチルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-メチルフェニル) ホスフィノ}ブタン]、[2,3-ビス(tert-ブチルジメチ ルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-メチルフェニル)ホス フィノ}ブタン〕、〔2,3-ビス(トリイソプロピルシロキ シ)-1,4-ビス{ジ(4-メチルフェニル)ホスフィノ}ブタ ン]、[2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス {ジ(4-メチルフェニル)ホスフィノ}ブタン〕、[2,3-ビス(トリメチルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-フルオロ フェニル)ホスフィノ}ブタン〕、〔2,3-ビス(tert-ブチ ルジメチルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-フルオロフェ ニル)ホスフィノ}ブタン〕、〔2,3-ビス(トリイソプロ ピルシロキシ)-1,4-ビス{ジ(4-フルオロフェニル) ホスフィノ}ブタン]、[2,3-ビス(トリフェニルシロキ シ)-1,4-ビス{ジ(4-フルオロフェニル)ホスフィノ} ブタン]に相当する化合物などが挙げられる。

[0024]

本発明の方法は、このような遷移金属錯体の存在下に一般式(3)で示されるオレフィン化合物と水素とを反応させるものであるが、ここで原料化合物であるオレフィン化合物において、R⁴、R⁵、

(1 and 5 -cyclooctadiene) {2 and 3 -bis (trimethyl silox y) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane }] SbF<s ub>6</sub>, [Rh (1 and 5 -cyclooctadiene) {2 and 3 -b is (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane }] BF₄, [RuCl₂ {2 an d 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphos phino) butane }] ₂ (N (C₂H<su b>5</sub>) ₃), Ru (O₂CCH<s ub>3</sub>) ₂ {2 and 3 -bis (trimethyl silo xy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane },IrCl {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphen ylphosphino) butane }, [Ir (1 and 5 -cyclooctadiene) {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphen vlphosphino) butane }] PF₆, PdCl<sub>2</s ub> {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (di phenylphosphino) butane }]

[0023]

And {2 and 3 -bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane }, {2 and 3 -bis (tri i sopropyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) bu tane }, {2 and 3 -bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane }, {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (dicyclohexyl phosphino) butane }, {2 and 3 -bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (dicyclohexyl phosphino) butane }, {2 and 3 -bis (t ri isopropyl siloxy) - 1 and 4 -bis (dicyclohexyl phosph ino) butane }, {2 and 3 -bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis (dicyclohexyl phosphino) butane }, {2 and 3 -bi s (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -methylphenyl) phosphino } butane }, {2 and 3 -bis (t- butyl dimeth yl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -methylphenyl) phosph ino } butane }, {2 and 3 -bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -methylphenyl) phosphino } butane }, {2 and 3 -bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -methylphenyl) phosphino } butane }, {2 and 3 -bis (trimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -fluorophenyl) phosphino } butane }, {2 and 3 -bis (t- butyl dimethyl s iloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -fluorophenyl) phosphino } butane }, {2 and 3 -bis (tri isopropyl siloxy) - 1 an d 4 -bis {di (4 -fluorophenyl) phosphino } butane }, co mpound etc which is suitable to {2 and 3 -bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis {di (4 -fluorophenyl) phosphin o } butane } you can list {2 and 3 -bis (trimethyl silox y) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane } in the above-mentioned each compound.

[0024]

method of this invention olefin compound and hydrogen which under existing of transition metal complex a this way are shown with general formula (3) is something w hichreacts, but as substituent which is shown with R<sup

R⁶ で示される置換基としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロヘキシル基、トリフルオロメチル基、トリクロロメチル基、メトキシメチル基、2-ヒドロキシエチル基、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、2-(エトキシカルボニル)エチル基、2-(エトキシカルボニル)エチル基、2-(エトキシカルボニル)エチル基、

[0025]

2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、 2.4.6-トリフルオロフェニル基、2-クロロフェニル 基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、2.4 -ジクロロフェニル基、2,4,6-トリクロロフェニル 基、2-メトキシフェニル基、3-メトキシフェニル 基、4-メトキシフェニル基、2,4-ジメトキシフェニル 基、3.4-ジメトキシフェニル基、2,3-メチレンジオ キシフェニル基、3,4-メチレンジオキシフェニル 基、2.4.6-トリメトキシフェニル基、2-ヒドロキシフ ェニル基、3-ヒドロキシフェニル基、4-ヒドロキシ フェニル基、2,4-ジヒドロキシフェニル基、3,4-ジ ヒドロキシフェニル基、2,4,6-トリヒドロキシフェニ ル基、4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル基、2-トリ ル基、3-トリル基、4-トリル基、2,4-ジメチルフェ ニル基、2,4,6-トリメチルフェニル基、ベンジル 基、フェネチル基、ジフェニルメチル基、ナフチ ルメチル基、2-ナフチルエチル基、

[0026]

カルボキシル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボキシル基、イソプロポキシカルボキシル基、n-ブトキシカルボキシル基、tert-ブトキシカルボキシル基、フェノキシカルボニル基などが挙げられる。

[0027]

置換基 A で示される一般式(4)で示される置換基において、X で示される低級アルキル基としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、なC-ブチル基、tert-ブチル基、シクロヘキシル基などのの低級アルキル基が例示される。

低級アルコキシル基としてはメトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソプトキシ基、tert-ブトキシ基などが例示される。

[0028]

一般式(5)で示される置換基において、R7、R8と

>4</sup>, R⁵, R⁶ in olefin com pound which is a starting material compound here, meth yl group, ethyl group, n- propyl group, isopropyl gro up, n- butyl group, isobutyl group, s-butyl group, t-butyl group, cyclohexyl group, trifluoromethyl group, trichloromethyl group, methoxymethyl group, 2- methox yethyl group, hydroxymethyl group, 2- hydroxyethyl group, methoxycarbonyl methyl group, ethoxy carbonyl methyl group, 2- (methoxycarbonyl) ethyl group, 2- (ethoxy carbonyl) ethyl group,

[0025]

2 -fluorophenyl group, 3- fluorophenyl group, 4- fluoro phenyl group, 2, 4- difluoro phenyl group, 2, 4, 6-trifl uoro phenyl group, 2- chlorophenyl group, 3- chloroph enyl group, 4- chlorophenyl group, 2, 4- dichloropheny l group, 2, 4, 6-trichlorophenyl group, 2- methoxyphen yl group, 3- methoxyphenyl group, 4- methoxyphenyl group, 2, 4- dimethoxy phenyl group, 3, 4- dimethoxy phenyl group, 2, 3- methylene dioxy phenyl group, 3, 4- methylene dioxy phenyl group, 2, 4, 6-trimethoxy p henyl group, 2- hydroxyphenyl group, 3- hydroxypheny 1 group, 4- hydroxyphenyl group, 2, 4- dihydroxy phen yl group, 3, 4- dihydroxy phenyl group, 2, 4, 6-trihydr oxy phenyl group, ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate m ethoxyphenyl group, 2- tolyl group, 3- tolyl group, 4tolyl group, 2, 4- dimethylphenyl group, 2, 4, 6-trime thyl phenyl group , benzyl group , phenethyl group , dip henylmethyl group, naphthyl methyl group, 2- naphthyl ethyl group,

[0026]

You can list carboxyl group, methoxycarbonyl group, e thoxy carbonyl group, n- propoxy carboxyl group, isop ropoxy carboxyl group, n- butoxy carboxyl group, t- b utoxy carboxyl group, phenoxy carbonyl group etc.

[0027]

lower alkyl group of methyl group , ethyl group , n- pr opyl group , isopropyl group , n- butyl group , isobutyl group , s-butyl group , t- butyl group , cyclohexyl group or other is illustrated as lower alkyl group which is sho wn with X in substituent which is shown with general f ormula (4) which is shownwith substituent A.

methoxy group , ethoxy group , n- propoxy group , isop ropoxy group , n- butoxy group , isobutoxy group , s -b utoxy group , t- butoxy group etc is illustrated as lower alkoxy group .

[0028]

methyl group , ethyl group , n- propyl group , isopropyl

して示される低級アルキル基としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブ チル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロヘキシル基などの鎖状もしくは環状の低級アルキル基などが例示され、かかる置換基としては、例えばアミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、tert-ブチルアミノ基、シクロヘキシルメチルアミノ基などが挙げられる。

R⁷、R⁸とが結合してN原子とともに環を形成している場合の一般式(5)で示される置換基としては1-ピロリジニル基、1-ピロリニル基、1-イミダゾリニル基、1-ピラゾリニル基、1-ピペロジニル基、1-モルホリニル基、1-インドリニル基、イソインドリニル基、cis-ヘキサヒドロ-1-インドリニル基、cis-ヘキサヒドロ-2-イソインドリニル基、cis-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-2-イソインドリニル基、trans-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-2-イソインドリニル基などが例示される。

[0029]

一般式(6)で示される置換基において置換基 R % R¹⁰ における低級アルキル基としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、なec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロヘキシル基などの鎖状もしくは環状の低級アルキル基が、アシル基としてはホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ベンゾイル基、フタロイル基などがそれぞれ例示される。

[0030]

かかるオレフィン化合物としては、

例えばメタクリル酸、

trans-ブテン酸、

cis-ブテン酸、

trans-2-メチルブテン酸、

cis-2-メチルブテン酸、

trans-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸、

cis-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸、

trans-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸、

cis-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸、

trans-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸、

group , n- butyl group , isobutyl group , s-butyl group , t- butyl group , cyclohexyl group or other chain or lo wer alkyl group etc of cyclic are illustrated as lower alk yl group which is shown in substituent which is shown with general formula (5), as the R⁷, R⁸, can list for example amino group , methylamin o group , ethylamino group , t- butyl amino group , dim ethylamino group , methyl t- butyl amino group , cycloh exyl methylamino group etc as this substituent .

R⁷, R⁸ connecting, 1 -pyrrolidin yl group , 1- pyrrolinyl group , 1- imidazolinyl group , 1- pyrazolinyl group , 1- [piperojiniru] basis, 1 -morpho linyl group , 1- indolinyl group , isoindolinyl group , cis-hexahydro -1- indolinyl group , trans -hexahydro -1- indolinyl group , trans -hexahydro -2- isoindolinyl group , trans -3a, 4, 7, 7a-tetr ahydro -2- isoindolinyl group , trans -3a, 4, 7, 7a-tetrahydro -2- isoindolinyl group etc is illustratedwith Natom as substituent which is shown with general formula (5) wh en ringis formed.

[0029]

As lower alkyl group in substituent R⁹, R<s up>10</sup> in substituent which is shown with general formula (6) lower alkyl group of methyl group , ethyl group , n- propyl group , isopropyl group , n- butyl group , isobutyl group , s-butyl group , t- butyl group , cyclo hexyl group or other chain or cyclic , formyl group , ac etyl group , acetoacetyl group , propanoyl group , butyry l group , isobutyryl group , benzoyl group , phthaloyl group etc is respectivelyillustrated as acyl group .

[0030]

As this olefin compound,

for example methacrylic acid,

trans -butenoic acid,

cis-butenoic acid,

trans -2- methyl butenoic acid,

cis-2- methyl butenoic acid,

trans -ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- bute noic acid ,

cis-ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- butenoi c acid ,

trans -5-hydroxy -3- methyl -2- pentenoic acid,

cis-5-hydroxy -3- methyl -2- pentenoic acid,

trans -2- ethylidene -3- hydroxy propanoic acid,

Page 16 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

cis-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸、trans-2-ヘキセン酸、

桂皮酸、

o-フルオロ桂皮酸、

o-クロロ桂皮酸、

o-ブロモ桂皮酸、

o-メトキシ桂皮酸、

o-ヒドロキシ桂皮酸、

m-フルオロ桂皮酸、

m-クロロ桂皮酸、

m-ブロモ桂皮酸、

m-メトキシ桂皮酸、

m-ヒドロキシ桂皮酸、

p-フルオロ桂皮酸、

p-クロロ桂皮酸、

p-ブロモ桂皮酸、

p-メトキシ桂皮酸、

p-ヒドロキシ桂皮酸、

2,3-ジメトキシ桂皮酸、

3,4-ジメトキシ桂皮酸、 3,4,5-トリメトキシ桂皮酸、

2-メチレンフェニル酢酸、2-メチレン-o-フルオロ フェニル酢酸、2-メチレン-o-クロロフェニル酢 酸、2-メチレン-o-ブロモフェニル酢酸、2-メチレン -o-メトキシフェニル酢酸、2-メチレン-o-ヒドロキ シフェニル酢酸、、2-メチレン-m-フルオロフェニ ル酢酸、2-メチレン-m-クロロフェニル酢酸、2-メ チレン-m-ブロモフェニル酢酸、2-メチレン-m-メト キシフェニル酢酸、2-メチレン-m-ヒドロキシフェ ニル酢酸、、2-メチレン-p-フルオロフェニル酢 酸、2-メチレン-p-クロロフェニル酢酸、2-メチレン -p-ブロモフェニル酢酸、2-メチレン-p-メトキシフ ェニル酢酸、2-メチレン-p-ヒドロキシフェニル酢 酸、2-メチレン-2、3-ジメトキシフェニル酢酸、2-メ チレン-3,4-ジメトキシフェニル酢酸、2-メチレン-3.4.5-トリメトキシフェニル酢酸、イタコン酸、2-メ チルイタコン酸、2-エチルイタコン酸、2-エチリデ ンこはく酸、2-ベンジリデンこはく酸、2-(o-フルオ ロベンジリデン)こはく酸、2-(o-クロロベンジリデ ン)こはく酸、2-(o-ブロモベンジリデン)こはく酸、 2-(o-メトキシベンジリデン)こはく酸、2-(o-ヒドロ キシベンジリデン)こはく酸、2-(m-フルオロベン cis-2- ethylidene -3- hydroxy propanoic acid ,
trans -2- hexenoic acid ,
cinnamic acid ,
o-fluoro cinnamic acid ,
o-chloro cinnamic acid ,
o-bromo cinnamic acid ,
o-methoxycinnamic acid ,
o-hydroxy cinnamic acid ,
m-fluoro cinnamic acid ,

 $\begin{array}{lll} \text{m-chloro cinnamic acid} \ , \\ \\ \text{m-bromo cinnamic acid} \ , \end{array}$

m-methoxycinnamic acid,

m-hydroxy cinnamic acid,

p- fluoro cinnamic acid,

p- chloro cinnamic acid,

p- bromo cinnamic acid,

p- methoxycinnamic acid,

p- hydroxy cinnamic acid,

2 and 3 -dimethoxy cinnamic acid,

3 and 4 -dimethoxy cinnamic acid,

3, 4 and 5 -trimethoxy cinnamic acid,

2 -methylene phenylacetic acid , 2- methylene -o-fluorop henyl acetic acid, 2- methylene -o-chlorophenyl acetic a cid , 2- methylene -o-bromophenyl acetic acid , 2- meth ylene -o-methoxyphenyl acetic acid , 2- methylene -o-hyd roxyphenyl acetic acid, 2- methylene -m-fluorophenyl ac etic acid, 2- methylene -m-chlorophenyl acetic acid, 2methylene -m-bromophenyl acetic acid, 2- methylene m-methoxyphenyl acetic acid, 2- methylene -m-hydroxyp henyl acetic acid, 2- methylene -p- fluorophenyl acetic acid, 2- methylene -p- chlorophenyl acetic acid, 2- met hylene -p- bromophenyl acetic acid , 2- methylene -p- m ethoxyphenyl acetic acid, 2- methylene -p- hydroxyphen yl acetic acid, 2- methylene -2, 3- dimethoxy phenylace tic acid, 2- methylene -3, 4- dimethoxy phenylacetic aci d . 2- methylene -3, 4, 5-trimethoxy phenylacetic acid, itaconic acid, 2- methyl itaconic acid, 2- ethyl itaconic acid, 2- ethylidene succinic acid, 2- benzilidine succin ic acid, 2- (o-fluoro benzilidine) succinic acid, 2- (o-c hloro benzilidine) succinic acid , 2- (o-bromo benzilidin e) succinic acid, 2- (o-methoxy benzilidine) succinic a cid , 2- (o-hydroxy benzilidine) succinic acid , 2- (m-fl

ジリデン)こはく酸、2-(m-クロロベンジリデン)こ はく酸、2-(m-ブロモベンジリデン)こはく酸、2-(m -メトキシベンジリデン)こはく酸、2-(m-ヒドロキシ ベンジリデン)こはく酸、2-(p-フルオロベンジリデ ン)こはく酸、2-(p-クロロベンジリデン)こはく酸、2 -(p-ブロモベンジリデン)こはく酸、2-(p-メトキシベ ンジリデン)こはく酸、2-(p-ヒドロキシベンジリデ ン)こはく酸、2-(2,3-ジメトキシベンジリデン)こは く酸、2-(3,4-ジメトキシベンジリデン)こはく酸、2-(2,3-メチレンジオキシベンジリデン)こはく酸、2-(3、4-メチレンジオキシベンジリデン)こはく酸、2-(3,4,5-トリメトキシベンジリデン)こはく酸、2-(1-ナ フチルメチレン)こはく酸、2-(1-(5-メトキシ)ナフチ ルメチレン)こはく酸、2-(1-(6-メトキシ)ナフチルメ チレン)こはく酸、2-(2-ナフチルメチレン)こはく 酸、2-(2-(5-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸、 2-(2-(6-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸、

[0031]

メタクリル酸メチル、

trans-ブテン酸メチル、

cis-ブテン酸メチル、

trans-2-メチルブテン酸メチル、

cis-2-メチルブテン酸メチル、

trans-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸メチル、

cis-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸メチル、

trans-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸メチル、

cis-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸メチル、

trans-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸メチル、

cis-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸メチル、

trans-2-ヘキセン酸メチル、

桂皮酸メチル、

o-フルオロ桂皮酸メチル、

o-クロロ桂皮酸メチル、

o-ブロモ桂皮酸メチル、

o-メトキシ桂皮酸メチル、

o-ヒドロキシ桂皮酸メチル、

uoro benzilidine) succinic acid , 2- (m-chloro benzilidin e) succinic acid , 2- (m-bromo benzilidine) succinic ac id, 2- (m-methoxy benzilidine) succinic acid, 2- (m-h ydroxy benzilidine) succinic acid , 2- (p- fluoro benzilid ine) succinic acid, 2- (p- chloro benzilidine) succinic acid, 2- (p- bromo benzilidine) succinic acid, 2- (pmethoxy benzilidine) succinic acid , 2- (p- hydroxy ben zilidine) succinic acid , 2- (2 and 3 -dimethoxy benzilid ine) succinic acid , 2- (3 and 4 -dimethoxy benzilidine) succinic acid , 2- (2 and 3 -methylene dioxy benzilidi ne) succinic acid , 2- (3 and 4 -methylene dioxy benzil idine) succinic acid, 2- (3, 4 and 5 -trimethoxy benzili dine) succinic acid, 2- (1 -naphthyl methylene) succin ic acid, 2- (1 - (5 -methoxy) naphthyl methylene) suc cinic acid, 2- (1 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) succinic acid, 2- (2 -naphthyl methylene) succinic acid , 2- (2 - (5 -methoxy) naphthyl methylene) succinic a cid , 2- (2 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) succini c acid,

[0031]

methyl methacrylate,

trans -butenoic acid methyl,

cis-butenoic acid methyl,

trans -2- methyl butenoic acid methyl,

cis-2- methyl butenoic acid methyl,

trans -ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- bute noic acid methyl ,

cis-ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- butenoi c acid methyl ,

trans -5-hydroxy -3- methyl -2- methyl pentenoate,

cis-5-hydroxy -3- methyl -2- methyl pentenoate,

trans -2- ethylidene -3- hydroxy methyl propionate,

cis-2- ethylidene -3- hydroxy methyl propionate,

trans -2- hexenoic acid methyl,

cinnamic acid methyl,

o-fluoro cinnamic acid methyl,

o-chloro cinnamic acid methyl,

o-bromo cinnamic acid methyl,

o-methoxycinnamic acid methyl,

o-hydroxy cinnamic acid methyl,

Page 18 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

- m-フルオロ桂皮酸メチル、
- m-クロロ桂皮酸メチル、
- m-ブロモ桂皮酸メチル、
- m-メトキシ桂皮酸メチル、
- m-ヒドロキシ桂皮酸メチル、
- p-フルオロ桂皮酸メチル、
- p-クロロ桂皮酸メチル、
- p-ブロモ桂皮酸メチル、
- p-メトキシ桂皮酸メチル、
- p-ヒドロキシ桂皮酸メチル、
- 2.3-ジメトキシ桂皮酸メチル、
- 3,4-ジメトキシ桂皮酸メチル、
- 3,4,5-トリメトキシ桂皮酸メチル、
- 2-メチレンフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-o-フルオロフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-o-クロロフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-o-ブロモフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-o-メトキシフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-o-ヒドロキシフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-m-フルオロフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-m-クロロフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-m-ブロモフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-m-メトキシフェニル酢酸メチル、 2-メチレン-m-ヒドロキシフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-p-フルオロフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-p-クロロフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-p-ブロモフェニル酢酸メチル、
- 2-メチレン-p-メトキシフェニル酢酸メチル、

2-メチレン-p-ヒドロキシフェニル酢酸メチル、2-メ チレン-2,3-ジメトキシフェニル酢酸メチル、2-メチ レン-3,4-ジメトキシフェニル酢酸メチル、2-メチレ ン-3,4,5-トリメトキシフェニル酢酸メチル、イタコ ン酸モノメチルエステル、2-メチルイタコン酸モノ メチルエステル、2-エチルイタコン酸モノメチルエ ステル、2-エチリデンこはく酸モノメチルエステ ル、2-ベンジリデンこはく酸モノメチルエステル、2-(o-フルオロベンジリデン)こはく酸モノメチルエ ステル、2-(o-クロロベンジリデン)こはく酸モノメ チルエステル、2-(o-ブロモベンジリデン)こはく酸

- m-fluoro cinnamic acid methyl,
- m-chloro cinnamic acid methyl,
- m-bromo cinnamic acid methyl,
- m-methoxycinnamic acid methyl,
- m-hydroxy cinnamic acid methyl,
- p- fluoro cinnamic acid methyl,
- p- chloro cinnamic acid methyl,
- p- bromo cinnamic acid methyl,
- p- methoxycinnamic acid methyl,
- p- hydroxy cinnamic acid methyl,
- 2 and 3 -dimethoxy cinnamic acid methyl,
- 3 and 4 -dimethoxy cinnamic acid methyl,
- 3. 4 and 5 -trimethoxy cinnamic acid methyl,
- 2 -methylene phenylacetic acid methyl,
- 2 -methylene -o-fluorophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -o-chlorophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -o-bromophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -o-methoxyphenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -o-hydroxyphenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -m-fluorophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -m-chlorophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -m-bromophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -m-methoxyphenyl methyl acetate ,
- 2 -methylene -m-hydroxyphenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -p- fluorophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -p- chlorophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -p- bromophenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -p- methoxyphenyl methyl acetate,
- 2 -methylene -p- hydroxyphenyl methyl acetate , 2- meth ylene -2, 3- dimethoxy phenylacetic acid methyl , 2- met hylene -3, 4- dimethoxy phenylacetic acid methyl , 2- m ethylene -3, 4, 5-trimethoxy phenylacetic acid methyl , m onomethyl itaconate ester , 2- methyl monomethyl itaconate ester , 2- ethyl monomethyl itaconate ester , 2- ethyl idene succinic acid mono methyl ester , 2- benzilidine su ccinic acid mono methyl ester , 2- (o-fluoro benzilidine) succinic acid mono methyl ester , 2- (o-chloro benzilidine) succinic acid mono methyl ester , 2- (o-bromo benzilidine) succinic acid mono methyl ester , 2- (o-methox

モノメチルエステル、2-(o-メトキシベンジリデン) こはく酸モノメチルエステル、2-(o-ヒドロキシベン ジリデン)こはく酸モノメチルエステル、2-(m-フル オロベンジリデン)こはく酸モノメチルエステル、2 -(m-クロロベンジリデン)こはく酸モノメチルエス テル、2-(m-ブロモベンジリデン)こはく酸モノメチ ルエステル、2-(m-メトキシベンジリデン)こはく酸 モノメチルエステル、2-(m-ヒドロキシベンジリデ ン)こはく酸モノメチルエステル、2-(p-フルオロベ ンジリデン)こはく酸モノメチルエステル、2-(p-ク ロロベンジリデン)こはく酸モノメチルエステル、2 -(p-ブロモベンジリデン)こはく酸モノメチルエス テル、2-(p-メトキシベンジリデン)こはく酸モノメチ ルエステル、2-(p-ヒドロキシベンジリデン)こはく 酸モノメチルエステル、2-(2,3-ジメトキシベンジリ デン)こはく酸モノメチルエステル、2-(3,4-ジメト キシベンジリデン)こはく酸モノメチルエステル、2 -(2,3-メチレンジオキシベンジリデン)こはく酸モノ メチルエステル、2-(3,4-メチレンジオキシベンジ リデン)こはく酸モノメチルエステル、2-(3,4,5-トリ メトキシベンジリデン)こはく酸モノメチルエステ ル、2-(1-ナフチルメチレン)こはく酸モノメチルエ ステル、2-(1-(5-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく 酸モノメチルエステル、2-(1-(6-メトキシ)ナフチル メチレン)こはく酸モノメチルエステル、2-(2-ナフ チルメチレン)こはく酸モノメチルエステル、2-(2-(5-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸モノメチル エステル、2-(2-(6-)ノトキシ ナフチルメチレン)こ はく酸モノメチルエステル、

[0032]

メタクリル酸エチル、

trans-ブテン酸エチル、

cis-ブテン酸エチル、

trans-2-メチルブテン酸エチル、

cis-2-メチルブテン酸エチル、

trans-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸エチル、

cis-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸エチル、

trans-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸エチル、

cis-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸エチル、

trans-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸エチル、

cis-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸エチル、

y benzilidine) succinic acid mono methyl ester, 2- (o-h vdroxy benzilidine) succinic acid mono methyl ester, 2 - (m-fluoro benzilidine) succinic acid mono methyl ester , 2- (m-chloro benzilidine) succinic acid mono methyl ester, 2- (m-bromo benzilidine) succinic acid mono me thyl ester, 2- (m-methoxy benzilidine) succinic acid mo no methyl ester, 2- (m-hydroxy benzilidine) succinic ac id mono methyl ester, 2- (p- fluoro benzilidine) succin ic acid mono methyl ester, 2- (p- chloro benzilidine) s uccinic acid mono methyl ester, 2- (p- bromo benzilidin e) succinic acid mono methyl ester, 2- (p- methoxy be nzilidine) succinic acid mono methyl ester , 2- (p- hydr oxy benzilidine) succinic acid mono methyl ester, 2-(2 and 3 -dimethoxy benzilidine) succinic acid mono m ethyl ester, 2- (3 and 4 -dimethoxy benzilidine) succini c acid mono methyl ester, 2- (2 and 3 -methylene diox y benzilidine) succinic acid mono methyl ester, 2-(3 and 4 -methylene dioxy benzilidine) succinic acid mono methyl ester, 2- (3, 4 and 5 -trimethoxy benzilidine) succinic acid mono methyl ester, 2- (1 -naphthyl methyl ene) succinic acid mono methyl ester, 2- (1 - (5 -met hoxy) naphthyl methylene) succinic acid mono methyl ester . 2- (1 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) succi nic acid mono methyl ester, 2- (2 -naphthyl methylene) succinic acid mono methyl ester, 2- (2 - (5 -methox y) naphthyl methylene) succinic acid mono methyl este r, 2- (2 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) succinic acid mono methyl ester,

[0032]

ethyl methacrylate,

trans -butenoic acid ethyl,

cis-butenoic acid ethyl,

trans -2- methyl butenoic acid ethyl,

cis-2- methyl butenoic acid ethyl,

trans -ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- bute noic acid ethyl ,

cis-ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- butenoi c acid ethyl,

trans -5-hydroxy -3- methyl -2- pentenoic acid ethyl,

cis-5-hydroxy -3- methyl -2- pentenoic acid ethyl,

trans -2- ethylidene -3- hydroxy ethyl propionate,

cis-2- ethylidene -3- hydroxy ethyl propionate,

Page 20 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

JP1998130175A

trans-2-ヘキセン酸エチル、 桂皮酸エチル、 ο-フルオロ桂皮酸エチル、 o-クロロ桂皮酸エチル、 o-ブロモ桂皮酸エチル、 ο-メトキシ桂皮酸エチル、 o-ヒドロキシ桂皮酸エチル、 m-フルオロ桂皮酸エチル、 m-クロロ桂皮酸エチル、 m-ブロモ桂皮酸エチル、 m-メトキシ桂皮酸エチル、 m-ヒドロキシ桂皮酸エチル、 p-フルオロ桂皮酸エチル、 p-クロロ桂皮酸エチル、 p-ブロモ桂皮酸エチル、 p-メトキシ桂皮酸エチル、 p-ヒドロキシ桂皮酸エチル、 2.3-ジメトキシ桂皮酸エチル、 3.4-ジメトキシ桂皮酸エチル、 3,4,5-トリメトキシ桂皮酸エチル、 2-メチレンフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-o-フルオロフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-o-クロロフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-o-ブロモフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-α-メトキシフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-o-ヒドロキシフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-m-フルオロフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-m-クロロフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-m-ブロモフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-m-メトキシフェニル酢酸、 2-メチレン-m-ヒドロキシフェニル酢酸、 2-メチレン-p-フルオロフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-p-クロロフェニル酢酸エチル、 2-メチレン-p-ブロモフェニル酢酸エチル、

2-メチレン-p-メトキシフェニル酢酸エチル、

trans -2- hexenoic acid ethyl, cinnamic acid ethyl, o-fluoro cinnamic acid ethyl, o-chloro cinnamic acid ethyl, o-bromo cinnamic acid ethyl, o-methoxycinnamic acid ethyl, o-hydroxy cinnamic acid ethyl, m-fluoro cinnamic acid ethyl, m-chloro cinnamic acid ethyl, m-bromo cinnamic acid ethyl, m-methoxycinnamic acid ethyl, m-hydroxy cinnamic acid ethyl, p- fluoro cinnamic acid ethyl, p- chloro cinnamic acid ethyl, p- bromo cinnamic acid ethyl, p- methoxycinnamic acid ethyl, p- hydroxy cinnamic acid ethyl, 2 and 3 -dimethoxy cinnamic acid ethyl, 3 and 4 -dimethoxy cinnamic acid ethyl, 3, 4 and 5 -trimethoxy cinnamic acid ethyl, 2 -methylene ethyl phenylacetate, 2 -methylene -o-fluorophenyl ethylacetate, 2 -methylene -o-chlorophenyl ethylacetate, 2 -methylene -o-bromophenyl ethylacetate, 2 -methylene -o-methoxyphenyl ethylacetate, 2 -methylene -o-hydroxyphenyl ethylacetate, 2 -methylene -m-fluorophenyl ethylacetate, 2 -methylene -m-chlorophenyl ethylacetate, 2 -methylene -m-bromophenyl ethylacetate, 2 -methylene -m-methoxyphenyl acetic acid, 2 -methylene -m-hydroxyphenyl acetic acid, 2 -methylene -p- fluorophenyl ethylacetate, 2 -methylene -p- chlorophenyl ethylacetate, 2 -methylene -p- bromophenyl ethylacetate,

2 -methylene -p- methoxyphenyl ethylacetate,

Page 21 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

2-メチレン-p-ヒドロキシフェニル酢酸エチル、2-メチレン-2,3-ジメトキシフェニル酢酸エチル、2-メ チレン-3,4-ジメトキシフェニル酢酸エチル、2-メ チレン-3,4,5-トリメトキシフェニル酢酸エチル、イ タコン酸モノエチルエステル、2-メチルイタコン酸 モノエチルエステル、2-エチルイタコン酸モノエ チルエステル、2-エチリデンこはく酸モノエチル エステル、2-ベンジリデンこはく酸モノエチルエ ステル、2-(o-フルオロベンジリデン)こはく酸モノ エチルエステル、2-(o-クロロベンジリデン)こはく 酸モノエチルエステル、2-(o-ブロモベンジリデ ン)こはく酸モノエチルエステル、2-(o-メトキシベ ンジリデン)こはく酸モノエチルエステル、2-(o-ヒ ドロキシベンジリデン)こはく酸モノエチルエステ ル、2-(m-フルオロベンジリデン)こはく酸モノエチ ルエステル、2-(m-クロロベンジリデン)こはく酸 モノエチルエステル、2-(m-ブロモベンジリデン) こはく酸モノエチルエステル、2-(m-メトキシベン ジリデン)こはく酸モノエチルエステル、2-(m-ヒド ロキシベンジリデン)こはく酸モノエチルエステ ル、2-(p-フルオロベンジリデン)こはく酸モノエチ ルエステル、2-(p-クロロベンジリデン)こはく酸モ ノエチルエステル、2-(p-ブロモベンジリデン)こは く酸モノエチルエステル、2-(p-メトキシベンジリデ ン)こはく酸モノエチルエステル、2-(p-ヒドロキシ ベンジリデン)こはく酸モノエチルエステル、2-(2, 3-ジメトキシベンジリデン)こはく酸モノエチルエ ステル、2-(3,4-ジメトキシベンジリデン)こはく酸 モノエチルエステル、2-(2,3-メチレンジオキシベ ンジリデン)こはく酸モノエチルエステル、2-(3.4-メチレンジオキシベンジリデン)こはく酸モノエチ ルエステル、2-(3,4,5-トリメトキシベンジリデン)こ はく酸モノエチルエステル、2-(1-ナフチルメチレ ン)こはく酸モノエチルエステル、2-(1-(5-メトキ シ)ナフチルメチレン)こはく酸モノエチルエステ ル、2-(1-(6-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸モ ノエチルエステル、2-(2-ナフチルメチレン)こはく 酸モノエチルエステル、2-(2-(5-)ノトキシ ナフチ ルメチレン)こはく酸モノエチルエステル、2-(2-(6-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸モノエチルエ ステル、

[0033]

2 -methylene -p- hydroxyphenyl ethylacetate, 2- methyle ne -2, 3- dimethoxy ethyl phenylacetate, 2- methylene -3, 4- dimethoxy ethyl phenylacetate, 2- methylene -3, 4, 5-trimethoxy ethyl phenylacetate, itaconic acid mono et hyl ester, 2- methyl itaconic acid mono ethyl ester, 2ethyl itaconic acid mono ethyl ester, 2- ethylidene suc cinic acid mono ethyl ester, 2- benzilidine succinic acid mono ethyl ester, 2- (o-fluoro benzilidine) succinic ac id mono ethyl ester, 2- (o-chloro benzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (o-bromo benzilidine) succini c acid mono ethyl ester, 2- (o-methoxy benzilidine) su ccinic acid mono ethyl ester, 2- (o-hydroxy benzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (m-fluoro benzilidi ne) succinic acid mono ethyl ester , 2- (m-chloro benzil idine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (m-bromo be nzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (m-methox y benzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (m-hy droxy benzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2-(p- fluoro benzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (p- chloro benzilidine) succinic acid mono ethyl ester , 2- (p- bromo benzilidine) succinic acid mono ethyl e ster, 2- (p- methoxy benzilidine) succinic acid mono et hyl ester, 2- (p- hydroxy benzilidine) succinic acid mo no ethyl ester, 2- (2 and 3 -dimethoxy benzilidine) suc cinic acid mono ethyl ester, 2- (3 and 4 -dimethoxy be nzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (2 and 3 -methylene dioxy benzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (3 and 4 -methylene dioxy benzilidine) succin ic acid mono ethyl ester, 2- (3, 4 and 5 -trimethoxy be nzilidine) succinic acid mono ethyl ester, 2- (1 -naphth yl methylene) succinic acid mono ethyl ester, 2- (1 -(5 -methoxy) naphthyl methylene) succinic acid mono ethyl ester, 2- (1 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) succinic acid mono ethyl ester, 2- (2 -naphthyl methyl ene) succinic acid mono ethyl ester, 2- (2 - (5 -metho xy) naphthyl methylene) succinic acid mono ethyl ester , 2- (2 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) succinic a cid mono ethyl ester,

[0033]

dimethyl itaconate , 2- methyl dimethyl itaconate , 2- eth yl dimethyl itaconate , 2- ethylidene dimethyl succinate , 2- benzilidine dimethyl succinate , 2- (o-fluoro benzilidine) dimethyl succinate , 2- (o-chloro benzilidine) dimethyl succinate , 2- (o-bromo benzilidine) dimethyl succinate , 2- (o-methoxy benzilidine) dimethyl succinate , 2- (o-hydroxy benzilidine) dimethyl succinate , 2- (m-fluoro benzilidine) dimethyl succinate , 2- (m-chloro benzilidine) dimethyl succinate , 2- (m-bromo benzilidine) dimethyl succinate , 2- (m-methoxy benzilidine) dimethyl

Page 22 Paterra® InstantMT® Machine Translation (US Patent 6,490,548). Translated and formatted in Tsukuba, Japan.

ジリデン)こはく酸ジメチル、2-(m-メトキシベンジ リデン)こはく酸ジメチル、2-(m-ヒドロキシベンジ リデン)こはく酸ジメチル、2-(p-フルオロベンジリ デン)こはく酸ジメチル、2-(p-クロロベンジリデン) こはく酸ジメチル、2-(p-ブロモベンジリデン)こは く酸ジメチル、2-(p-メトキシベンジリデン)こはく酸 ジメチル、2-(p-ヒドロキシベンジリデン)こはく酸 ジメチル、2-(2,3-ジメトキシベンジリデン)こはく 酸ジメチル、2-(3,4-ジメトキシベンジリデン)こは く酸ジメチル、2-(2,3-メチレンジオキシベンジリデ ン)こはく酸ジメチル、2-(3,4-メチレンジオキシベ ンジリデン)こはく酸ジメチル、2-(3,4,5-トリメトキ シベンジリデン)こはく酸ジメチル、2-(1-ナフチル メチレン)こはく酸ジメチル、2-(1-(5-メトキシ)ナフ チルメチレン)こはく酸ジメチル、2-(1-(6-メトキシ) ナフチルメチレン)こはく酸ジメチル、2-(2-ナフチ ルメチレン)こはく酸ジメチル、2-(2-(5-メトキシ)ナ フチルメチレン)こはく酸ジメチル、2-(2-(6-メトキ シ)ナフチルメチレン)こはく酸ジメチル、

[0034]

イタコン酸ジエチル、2-メチルイタコン酸ジエチ ル、2-エチルイタコン酸ジエチル、2-エチリデンこ はく酸ジエチル、2-ベンジリデンこはく酸ジエチ ル、2-(o-フルオロベンジリデン)こはく酸ジエチ ル、2-(o-クロロベンジリデン)こはく酸ジエチル、 2-(o-ブロモベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(o-メトキシベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(o-ヒ ドロキシベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(m-フ ルオロベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(m-ク ロロベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(m-ブロ モベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(m-メトキシ ベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(m-ヒドロキシ ベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(p-フルオロベ ンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(p-クロロベンジ リデン)こはく酸ジエチル、2-(p-ブロモベンジリデ ン)こはく酸ジエチル、2-(p-メトキシベンジリデン) こはく酸ジエチル、2-(p-ヒドロキシベンジリデン) こはく酸ジエチル、2-(2,3-ジメトキシベンジリデ ン)こはく酸ジエチル、2-(3,4-ジメトキシベンジリ デン)こはく酸ジエチル、2-(2,3-メチレンジオキシ ベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(3,4-メチレン ジオキシベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(3,4, 5-トリメトキシベンジリデン)こはく酸ジエチル、2-(1-ナフチルメチレン)こはく酸ジエチル、2-(1-(5-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸ジエチル、2-(1-(6-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸ジエチ ル、2-(2-ナフチルメチレン)こはく酸ジエチル、2-(2-(5-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸ジエチ ル、2-(2-(6-メトキシ)ナフチルメチレン)こはく酸ジ エチル、

[0035]

succinate, 2- (m-hydroxy benzilidine) dimethyl succinat e, 2- (p- fluoro benzilidine) dimethyl succinate, 2- (pchloro benzilidine) dimethyl succinate , 2- (p- bromo b enzilidine) dimethyl succinate , 2- (p- methoxy benzilidi ne) dimethyl succinate , 2- (p- hydroxy benzilidine) di methyl succinate, 2- (2 and 3 -dimethoxy benzilidine) dimethyl succinate, 2- (3 and 4 -dimethoxy benzilidine) dimethyl succinate, 2- (2 and 3 -methylene dioxy be nzilidine) dimethyl succinate , 2- (3 and 4 -methylene d ioxy benzilidine) dimethyl succinate , 2- (3, 4 and 5 -tr imethoxy benzilidine) dimethyl succinate , 2- (1 -naphth yl methylene) dimethyl succinate , 2- (1 - (5 -methoxy) naphthyl methylene) dimethyl succinate , 2- (1 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) dimethyl succinate, 2-(2 -naphthyl methylene) dimethyl succinate , 2- (2 -(5 -methoxy) naphthyl methylene) dimethyl succinate, 2- (2 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) dimethyl su ccinate,

[0034]

diethyl itaconate, 2- methyl diethyl itaconate, 2- ethyl diethyl itaconate, 2- ethylidene diethyl succinate, 2- be nzilidine diethyl succinate, 2- (o-fluoro benzilidine) diet hyl succinate, 2- (o-chloro benzilidine) diethyl succinat e, 2- (o-bromo benzilidine) diethyl succinate, 2- (o-m ethoxy benzilidine) diethyl succinate , 2- (o-hydroxy be nzilidine) diethyl succinate , 2- (m-fluoro benzilidine) diethyl succinate, 2- (m-chloro benzilidine) diethyl succ inate, 2- (m-bromo benzilidine) diethyl succinate, 2-(m-methoxy benzilidine) diethyl succinate , 2- (m-hydro xy benzilidine) diethyl succinate , 2- (p- fluoro benzilidi ne) diethyl succinate , 2- (p- chloro benzilidine) diethy 1 succinate, 2- (p- bromo benzilidine) diethyl succinate , 2- (p- methoxy benzilidine) diethyl succinate , 2- (phydroxy benzilidine) diethyl succinate, 2- (2 and 3 -d imethoxy benzilidine) diethyl succinate, 2- (3 and 4 -d imethoxy benzilidine) diethyl succinate, 2- (2 and 3 methylene dioxy benzilidine) diethyl succinate, 2- (3 a nd 4 -methylene dioxy benzilidine) diethyl succinate, 2 - (3, 4 and 5 -trimethoxy benzilidine) diethyl succinate , 2- (1 -naphthyl methylene) diethyl succinate , 2- (1 -(5 -methoxy) naphthyl methylene) diethyl succinate, 2- (1 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) diethyl succi nate, 2- (2 -naphthyl methylene) diethyl succinate, 2-(2 - (5 -methoxy) naphthyl methylene) diethyl succinat e, 2- (2 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) diethyl s uccinate,

[0035]

メタクリル酸アミド、

trans-ブテン酸アミド、

cis-ブテン酸アミド、

trans-2-メチルブテン酸アミド、

cis-2-メチルブテン酸アミド、

trans-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸アミド、

cis-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテン酸アミド、

trans-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸アミド、

cis-5-ヒドロキシ-3-メチル-2-ペンテン酸アミド、

trans-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸アミド、

cis-2-エチリデン-3-ヒドロキシプロピオン酸アミド

trans-2-ヘキセン酸アミド、

桂皮酸アミド、

- o-フルオロ桂皮酸アミド、
- o-クロロ桂皮酸アミド、
- o-ブロモ桂皮酸アミド、
- o-メトキシ桂皮酸アミド、
- o-ヒドロキシ桂皮酸アミド、
- m-フルオロ桂皮酸アミド、
- m-クロロ桂皮酸アミド、
- m-ブロモ桂皮酸アミド、
- m-メトキシ桂皮酸アミド、
- m-ヒドロキシ桂皮酸アミド、
- p-フルオロ桂皮酸アミド、
- p-クロロ桂皮酸アミド、
- p-ブロモ桂皮酸アミド、
- p-メトキシ桂皮酸アミド、
- p-ヒドロキシ桂皮酸アミド、
- 2,3-ジメトキシ桂皮酸アミド、
- 3,4-ジメトキシ桂皮酸アミド、
- 3,4,5-トリメトキシ桂皮酸アミド、
- 2-メチレンフェニル酢酸アミド、

methacrylamide,

trans -butenoic acid amide,

cis-butenoic acid amide,

trans -2- methyl butenoic acid amide,

cis-2- methyl butenoic acid amide,

trans -ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- bute

noic acid amide,

cis-ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate methyl -2- butenoi

c acid amide,

trans -5-hydroxy -3- methyl -2- pentenoic acid amide,

cis-5-hydroxy -3- methyl -2- pentenoic acid amide,

trans -2- ethylidene -3- hydroxy propanoic acid amide,

cis-2- ethylidene -3- hydroxy propanoic acid amide,

trans -2- hexenoic acid amide,

cinnamic acid amide,

o-fluoro cinnamic acid amide,

o-chloro cinnamic acid amide,

o-bromo cinnamic acid amide,

o-methoxycinnamic acid amide,

o-hydroxy cinnamic acid amide,

m-fluoro cinnamic acid amide,

m-chloro cinnamic acid amide,

m-bromo cinnamic acid amide,

m-methoxycinnamic acid amide,

m-hydroxy cinnamic acid amide,

p- fluoro cinnamic acid amide,

p- chloro cinnamic acid amide,

p- bromo cinnamic acid amide,

p- methoxycinnamic acid amide,

p- hydroxy cinnamic acid amide,

2 and 3 -dimethoxy cinnamic acid amide,

3 and 4 -dimethoxy cinnamic acid amide,

3, 4 and 5 -trimethoxy cinnamic acid amide,

2 -methylene phenylacetic acid amide,

- 2-メチレン-o-フルオロフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-o-クロロフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-o-ブロモフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-o-メトキシフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-o-ヒドロキシフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-m-フルオロフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-m-クロロフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-m-ブロモフェニル酢酸アミド、
- 2-メチレン-m-メトキシフェニル酢酸アミド、

2-メチレン-m-ヒドロキシフェニル酢酸アミド、2-メ チレン-p-フルオロフェニル酢酸アミド、2-メチレン -p-クロロフェニル酢酸アミド、2-メチレン-p-ブロ モフェニル酢酸アミド、2-メチレン-p-メトキシフェ ニル酢酸アミド、2-メチレン-p-ヒドロキシフェニル 酢酸アミド、2-メチレン-2,3-ジメトキシフェニル酢 酸アミド、2-メチレン-3,4-ジメトキシフェニル酢酸 アミド、2-メチレン-3,4,5-トリメトキシフェニル酢酸 アミド、イタコン酸モノアミド、2-メチルイタコン酸 モノアミド、2-エチルイタコン酸モノアミド、2-エチ リデンこはく酸モノアミド、2-ベンジリデンこはく酸 モノアミド、2-(o-フルオロベンジリデン)こはく酸 モノアミド、2-(o-クロロベンジリデン)こはく酸モノ アミド、2-(o-ブロモベンジリデン)こはく酸モノアミ ド、2-(o-メトキシベンジリデン)こはく酸モノアミ ド、2-(o-ヒドロキシベンジリデン)こはく酸モノアミ ド、2-(m-フルオロベンジリデン)こはく酸モノアミ ド、2-(m-クロロベンジリデン)こはく酸モノアミド、 2-(m-ブロモベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(m-メトキシベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(m-ヒドロキシベンジリデン)こはく酸モノアミド、2 -(p-フルオロベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(p-クロロベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(p-ブロモベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(p-メト キシベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(p-ヒドロ キシベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(2,3-ジメ トキシベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(3,4-ジ メトキシベンジリデン)こはく酸モノアミド、2-(2,3-メチレンジオキシベンジリデン)こはく酸モノアミ ド、2-(3,4-メチレンジオキシベンジリデン)こはく 酸モノアミド、2-(3,4,5-トリメトキシベンジリデン) こはく酸モノアミド、2-(1-ナフチルメチレン)こはく 酸モノアミド、2-(1-(5-メトキシ)ナフチルメチレン) こはく酸モノアミド、2-(1-(6-メトキシ)ナフチルメチ レン)こはく酸モノアミド、2-(2-ナフチルメチレン) こはく酸モノアミド、2-(2-(5-メトキシ)ナフチルメチ レン)こはく酸モノアミド、2-(2-(6-メトキシ)ナフチ ルメチレン)こはく酸モノアミド、

- 2 -methylene -o-fluorophenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -o-chlorophenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -o-bromophenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -o-methoxyphenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -o-hydroxyphenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -m-fluorophenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -m-chlorophenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -m-bromophenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -m-methoxyphenyl acetic acid amide,
- 2 -methylene -m-hydroxyphenyl acetic acid amide, 2- m ethylene -p- fluorophenyl acetic acid amide, 2- methylen e -p- chlorophenyl acetic acid amide, 2- methylene -pbromophenyl acetic acid amide, 2- methylene -p- metho xyphenyl acetic acid amide, 2- methylene -p- hydroxyph enyl acetic acid amide, 2- methylene -2, 3- dimethoxy phenylacetic acid amide, 2- methylene -3, 4- dimethoxy phenylacetic acid amide, 2- methylene -3, 4, 5-trimetho xy phenylacetic acid amide, itaconic acid mono amide, 2- methyl itaconic acid mono amide, 2- ethyl itaconic acid mono amide, 2- ethylidene succinic acid mono ami de, 2- benzilidine succinic acid mono amide, 2- (o-fluo ro benzilidine) succinic acid mono amide , 2- (o-chloro benzilidine) succinic acid mono amide , 2- (o-bromo b enzilidine) succinic acid mono amide , 2- (o-methoxy b enzilidine) succinic acid mono amide , 2- (o-hydroxy be nzilidine) succinic acid mono amide , 2- (m-fluoro benz ilidine) succinic acid mono amide , 2- (m-chloro benzili dine) succinic acid mono amide , 2- (m-bromo benzilidi ne) succinic acid mono amide , 2- (m-methoxy benzilidi ne) succinic acid mono amide , 2- (m-hydroxy benzilidi ne) succinic acid mono amide , 2- (p- fluoro benzilidin e) succinic acid mono amide, 2- (p- chloro benzilidine) succinic acid mono amide, 2- (p- bromo benzilidine) succinic acid mono amide, 2- (p- methoxy benzilidin e) succinic acid mono amide , 2- (p- hydroxy benzilidi ne) succinic acid mono amide , 2- (2 and 3 -dimethoxy benzilidine) succinic acid mono amide , 2- (3 and 4 dimethoxy benzilidine) succinic acid mono amide, 2-(2 and 3 -methylene dioxy benzilidine) succinic acid m ono amide, 2- (3 and 4 -methylene dioxy benzilidine) succinic acid mono amide, 2- (3, 4 and 5 -trimethoxy b enzilidine) succinic acid mono amide, 2- (1 -naphthyl methylene) succinic acid mono amide , 2- (1 - (5 -met hoxy) naphthyl methylene) succinic acid mono amide , 2- (1 - (6 -methoxy) naphthyl methylene) succinic aci d mono amide, 2- (2 -naphthyl methylene) succinic aci d mono amide, 2- (2 - (5 -methoxy) naphthyl methyle ne) succinic acid mono amide , 2- (2 - (6 -methoxy)

[0036]

2-ベンジリデン-3-(ピロリジニルカルボニル)プロ ピオン酸、2-ベンジリデン-3-(ピロリニルカルボニ ル)プロピオン酸、2-ベンジリデン-3-(1-イミダゾリ ニルカルボニル)プロピオン酸、2-ベンジリデン-3 -(1-ピラゾリニルカルボニル)プロピオン酸、2-ベ ンジリデン-3-(1-ピペロジニルカルボニル)プロピ オン酸、2-ベンジリデン-3-(1-モルホリニルカル ボニル)プロピオン酸、2-ベンジリデン-3-(1-イン ドリニルカルボニル)プロピオン酸、2-ベンジリデ ン-3-(1-イソインドリニルカルボニル)プロピオン 酸、2-ベンジリデン-3-(cis-ヘキサヒドロ-1-インド リニルカルボニル)プロピオン酸、2-ベンジリデン -3-(trans-ヘキサヒドロ-1-インドリニルカルボニ ル)プロピオン酸、2-ベンジリデン-3-(cis-ヘキサ ヒドロ-2-イソインドリニルカルボニル)プロピオン 酸、2-ベンジリデン-3-(trans-ヘキサヒドロ-2-イソ インドリニルカルボニル)プロピオン酸、2-ベンジ リデン-3-(cis-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-2-イソインド リニルカルボニル)プロピオン酸、2-ベンジリデン -3-(trans-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-2-イソインドリニ ルカルボニル)プロピオン酸、(Z)-N-アセチル-1-エチリデンベンジルアミン、(Z)-N-アセチル-1-プ ロピリデンベンジルアミン、(Z)-N-イソブチリル-1 -エチリデンベンジルアミン、(Z)-N-イソブチリル-」プロピリデンベンジルアミンなどが挙げられ る。

[0037]

本発明の方法に用いる遷移金属錯体における一般式(2)で示される 3 級ホスフィン化合物には前述のとおり 2 種類の光学活性体が存在し、本発明の方法においてはこれらいずれのものが用いられてもよいが、その(+)体を使用した場合に製造されるエタン誘導体と、その(-)体を使用した場合のエタン誘導体とは互いに鏡像異性体の関係になる。

従って、目的とするエタン誘導体の立体配置に応じて3級ホスフィン化合物としてその(+)体、(-)体のいずれかの光学活性体を用いた場合には、光学活性なエタン誘導体を製造することができる。

[0038]

遷移金属錯体の使用量は、オレフィン化合物に 対して通常 0.000001~0.5 モル倍、好ましくは 0.0 0001~0.05 モル倍の範囲である。

反応に際して通常は溶媒が用いられ、かかる溶 媒としては、例えばヘキサンなどの脂肪族炭化 水素類、トルエン、ベンゼンなどの芳香族炭化 naphthyl methylene) succinic acid mono amide , [0036]

2 -benzilidine -3- (pyrrolidinyl carbonyl) propanoic acid , 2- benzilidine -3- (pyrrolinyl carbonyl) propanoic aci d, 2- benzilidine -3- (1 -imidazolinyl carbonyl) propan oic acid, 2- benzilidine -3- (1 -pyrazolinyl carbonyl) pr opanoic acid, 2- benzilidine -3- (1 - [piperojinirukarubo niru]) propanoic acid, 2- benzilidine -3- (1 -morpholin yl carbonyl) propanoic acid , 2- benzilidine -3- (1 -indo linyl carbonyl) propanoic acid , 2- benzilidine -3- (1 -is oindolinyl carbonyl) propanoic acid, 2- benzilidine -3-(cis-hexahydro -1- indolinyl carbonyl) propanoic acid , 2- benzilidine -3- (trans -hexahydro -1- indolinyl carbony 1) propanoic acid, 2- benzilidine -3- (cis-hexahydro -2isoindolinyl carbonyl) propanoic acid , 2- benzilidine -3- (trans -hexahydro -2- isoindolinyl carbonyl) propanoic acid, 2- benzilidine -3- (cis-3a, 4, 7, 7a-tetrahydro -2isoindolinyl carbonyl) propanoic acid , 2- benzilidine -3-(trans -3a, 4, 7, 7a-tetrahydro -2- isoindolinyl carbonyl) propanoic acid , (Z) -N- acetyl -1- ethylidene benzyla mine, (Z) -N- acetyl -1- propylidene benzylamine, (Z) -N- isobutyryl -1- ethylidene benzylamine , (Z) you can list -N- isobutyryl -1- propylidene benzylamine etc.

[0037]

Aforementioned sort optical isomer of 2 kinds exists in t erniery phosphine compound which isshown with General Formula (2) in transition metal complex which is used for method of this invention regards to method of this in vention and these whichever onesmay be used, but when that (+) body is used, ethane derivative which isproduce d and, ethane derivative when that (-) body is used it be comes mutually relationshipof enantiomer.

Therefore, according to steric configuration of ethane derivative which is made objective as terniery phosphine compound, when it uses optical isomer of any of that (+) body and(-) body, it can produce optically active ethane derivative.

[0038]

amount used of transition metal complex is range of usu ally 0.000001 - 0.5 molar multiple , preferably 0.00001 - 0.05molar multiple vis-a-vis olefin compound .

It can use solvent usually at time of reaction, it can list the for example hexane or other aliphatic hydrocarbons , toluene , benzene or other aromatic hydrocarbon , chl 水素、クロルベンゼン、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素、メチルイソブチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類、メチルイソブチルケトンなどのケトン類、酢酸エチルなどのエステル類、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン性極性溶媒、メタノール、エタノール、水などのプロトン性極性溶媒が挙げられる。

これらの溶媒はそれぞれ単独もしくは 2 種以上を混合して用いられ、その使用量は特に制限されないが通常はオレフィン化合物に対して 2~20 重量倍の範囲である。

[0039]

反応においてはアミン化合物を添加して用いて もよい。

ここでアミン化合物としては、例えばトリメチルア ミン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミ ンアミン、ピロール、イミダゾール、ピリジン、モ ルホリンなどが挙げられる。

かかるアミン化合物を用いる場合、その使用量はオレフィン化合物に対して通常 0.1~5 モル倍、好ましくは 0.5~3 モル倍の範囲である。

[0040]

また、ハロゲン含有塩を添加して用いてもよい。

かかるハロゲン含有塩としては、例えばヨウ化 ナトリウム、ヨウ化カリウム、ヨウ化ルビジウム、 ヨウ化マグネシウム、ヨウ化カルシウム、ヨウ化 銅、ヨウ化亜鉛、ヨウ化スズ、ヨウ化アンチモン、 塩化ビスマス、臭化ビスマス、ヨウ化ビスマス、 ヨウ化マンガン、ヨウ化ニッケル、ヨウ化コバル ト、ヨウ化鉄、テトラヨード亜鉛(H)酸 N,N-ジメチ ルエフェドリウム、ヨウ化テトラ n-ブチルアンモニ ウム、ヨウ化 N-メチルキニニウム、塩化 N-ベン ジルキニジウム、ヨウ化 N-メチルキニジウム、ヨ ウ化(-)-N,N-ジメチルエフェドリニウム、ヨウ化 (+)-N、N-ジメチルエフェドリニウム、ヨウ化(-)-N-メチルキヌクリジウウム、ヨウ化(-)-N-メチルヒド ロキシキヌクリジウウム、ヨウ化(-)-N-ブチルヒド ロキシキヌクリジウウム、ヨウ化トリフェニルメチ ルホスホニウム、ヨウ化トリメチルスルホニウム 等が挙げられる。

かかるハロゲン含有塩をを用いる場合、その使用量は遷移金属錯体に対し通常 0.1~10 モル倍、好ましくは 1~5 モル倍の範囲である。

[0041]

水素は通常、水素ガスとして反応系に供給さ

orobenzene, dichloromethane or other halogenated hydro carbon, methyl isobutyl ether, dioxane, tetrahydrofuran or other ethers, methyl isobutyl ketone or other ketones, ethylacetate or other esters, dimethylformamide, dimethyl sulfoxide or other amount of aprotic polar solvent, methanol, ethanol, water or other protic polar solvent as this solvent.

These solvent are used mixing alone or two kinds or mo re respectively, amount used especially is not restricted, but of usually it is a range 2 - 20 weight multiple vis-a -vis olefin compound.

[0039]

Adding amine compound at time of reacting, it is possible to use.

You can list for example trimethyl amine, triethylamine, diisopropyl ethylamine amine, pyrrole, imidazole, pyridine, morpholine etc here as amine compound.

When this amine compound is used, amount used is ran ge of usually 0.1 - 5 molar multiple, preferably $0.5{\sim}3m$ olar multiple vis-a-vis olefin compound.

[0040]

In addition, adding halogen-containing salt, it is possible to use.

As this halogen-containing salt, for example sodium iodide, potassium iodide, rubidium iodide, magnesium iodide, calcium iodide, copper iodide, zinc iodide, iodide etin, iodide antimony, bismuth chloride, bromide bismuth, iodide bismuth, iodide manganese, nickel iodide, cobalt iodide, iron iodide, tetra iodo zinc (II) acid N, N- [jimechiruefedoriumu], iodide tetra n- butyl am monium, iodide N- methyl quininium, chloride N- [ben jirukinijiumu], iodide N- [mechirukinijiumu], the iodide (-) -N, N- [jimechiruefedoriniumu], iodide (+) -N, N- [jimechiruefedoriniumu], iodide (-) -N- [mechirukinukurijiuumu], iodide (-) -N- [mechiruhidorokishikinukurijiuumu], you can list triphenylmethyl iodide jp8 jp11 phosphonium, iodide trimethyl sulfonium etc.

When this halogen-containing salt is used, amount used is range of usually 0.1 - 10 molar multiple , preferably 1 ~5molar multiple vis-a-vis transition metal complex .

[0041]

hydrogen usually is supplied by reaction system as hydro

れ、その圧力は通常 0.5~100 気圧である。

また、この際、反応に対して不活性なガス、例えば窒素ガス、Ar ガスなどと混合した混合ガスとして用いてもよく、この場合には水素の分圧が通常 0.5~100 気圧の範囲となるように用いられる。

[0042]

反応は、例えば水素ガス雰囲気下に溶媒中でオレフィン化合物および遷移金属錯体を混合することにより行われ、反応温度は通常-50 deg C \sim 100 deg C、好ましくは-20 deg C \sim 50 deg C の範囲である。

反応終了後、濃縮、抽出、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製等の通常の後処理操作により目的のエタン誘導体を得ることができる。

[0043]

【発明の効果】

本発明の方法によれば、オレフィン化合物から エタン誘導体を良好な収率、選択性で得ること ができる。

[0044]

【実施例】

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明 するが、本発明は、これら実施例に限定される ものではない。

[0045]

参考例 1

(2R,3R)-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホ スフィノ)ブタンの製造

(R,R)-2,3-O-イソプロピリデン-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 0.31g(0.62 mmol)とp-トルエンスルホンサン1 水和物 25.0m g(0.13mmol)の混合物を、脱気した 95%エタノール 1.5mL 中で 24 時間還流した。

TLC により(R,R)-2,3-O-イソプロピリデン-2,3-ジ ヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン の消失を確認した後、水を加え、ジエチルエー テルで 10 回抽出した。

ジェチルエーテル層を全て合わせ、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を留去し、粗生成物 を得た。

これをシリカゲルクロマトグラフィー(移動層:ヘキ

gen gas, pressure isusually 0.5 - 100 atmosphere.

In addition, with time of this and vis-a-vis reaction it is possible to use inert gas, for example nitrogen gas, Ar gas etc as mixed gas which is mixed, in order incase of this for voltage division of hydrogen usually to become range of 0.5 - 100 atmosphere, it is used.

[0042]

Reaction is done by under for example hydrogen gas at mosphere mixing olefin compound and transition metal c omplex in solvent , reaction temperature of usually - is r ange 50 deg $C\sim100$ deg C, preferably -20deg $C\sim50$ deg C.

After reaction termination, ethane derivative of objective can be acquired withconcentration, extraction and [shirik agerukaramukuromatogurafii] with refining or other conventional post-treatment.

[0043]

[Effects of the Invention]

According to method of this invention, from olefin compound ethane derivative can beacquired with satisfactory yield, selectivity

[0044]

[Working Example (s)]

this invention furthermore is explained in detail below, w ith Working Example ,but this invention is not somethin g which is limited in these Working Example .

[0045]

Reference Example 1

diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis production of (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- dihydroxy -1, 4- bis (di phenylphosphino) butane

(R, R) - 2 and 3 -O-isopropylidene -2, 3- dihydroxy -1, 4- bis (diphenylphosphino) butane 0.31 g (0.62 mmol) with 24 hour reflux was done in 95%ethanol 1.5ml whi ch mixture of ethyl p-toluenesulfonate sun monohydrate 2 5.0mg (0.13 mmol), outgassing is done.

10 times it extracted with diethyl ether with TLC (R, R) - 2 and 3-O-isopropylidene -2, 3- dihydroxy -1, 4- bis after verifying disappearance of (diphenylphosphino) butane, includingwater.

diethyl ether layer all was adjusted, after drying with an hydrous sodium sulfate, the solvent was removed, crude product was acquired.

This was refined with [shirikagerukuromatogurafii] (mobi

サン/酢酸エチル=1/1 Rf=0.62)で精製し、(2R,3 R)-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 0.20g(0.44mmol)を得た。

(収率 71%)

融点:95~97 deg C(分解)

¹H-NMR(CDCl₃) δ -ppm:2.30(bs,2H,OH), 2.32 (d,4H,J=6.5Hz,CH₂), 3.60-3.80(m,2H,CH), 7.25 -7.50(m,20H,Ph)

マススペクトル:m/e(相対強度)458(M⁺,11), 273 (100)旋光度:[α]_D²⁵-33.1°(c 1.20,CHCl₃)

[0046]

参考例2

(2R,3R)-2,3-ビス(t-ブチルジメチルシロキシ)-1,4 -ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタンの製造

参考例 1

で得た(2R,3R)-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 29.5mg(0.064mmol)とトリエチルアミン 40 μ I(0.29mmol)とのジクロロメタン 0.1mL 溶液に、トリフルオロメタンスルホン酸 t-ブチルジメチルシリル 68.1mg(0.26mmol)を室温で加えた後、同温で 2 時間撹拌した。

次いで、水を加えヘキサンで抽出し、得られた 有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を 留去し粗生成物を得た。

これをシリカゲルクロマトグラフィー(移動層:へキサン/酢酸エチル=20/1 Rf=0.30)で精製した後、さらに高速液体クロマトグラフィー(カラム:Wakos il 5Sil 20mm×250mm,溶離液:ヘキサン/酢酸エチル=20/1)により精製して、(2R,3R)-2,3-ビス(t-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 30.5mg(0.044mmol)を得た(収率69%)。

融点:95~97 deg C(分解)

 1 H-NMR(CDCI₃) δ -ppm:-0.17(s,6H,SiCH₃), 0.0 0(s,6H,SiCH₃), 0.81(s,18H,Si-t-Bu), 2.14(dd,2 H,J=3.2,13.5Hz,CH₂), 2.55(dd,2H,J=1.5,13.5Hz, CH₂), 3.78-3.83(m,2H,CH), 7.25-7.50(m,20H,P h)

le layer :hexane /ethylacetate =1/1Rf =0.62), diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tar trate 3- dihydroxy -1, 4- bis (diphenylphosphino) butane 0.20g (0.44 mmol) was acquired.

(yield 71%)

melting point :95~97deg C (Disassembly)

¹H-nmr (CDCl₃);de -ppm :2.30
(bs, 2H, OH), 2.32 (d, 4H, J=6.5Hz , CH<sub>2</sub
>), 3.60 - 3.80 (m, 2H, CH), 7.25 - 7.50 (m, 20H, Ph
)

mass spectrum :m/e (relative intensity) 458 (M⁺, 11), 273 (100) optical rotation : [;al] <sub>D<sub>cup>25</sup>-33.1* (c1.20, CHCl₃)

[0046]

Reference Example 2

diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (t-butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis production of(diphenylphosphino) butane

Reference Example 1

So diisopropyl which is acquired (2 R,3R) - 2 and 3 - O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- dihydroxy -1, 4 - bis (diphenylphosphino) butane 29.5mg (0.064 mmol) with triethylamine 40;mu 1 (0.29 mmol) with to dichlo romethane 0.1 ml solution, after adding silver trifluorom ethane sulfonate jp11 Hong acid t-butyl dimethyl silyl 6 8.1mg (0.26 mmol) with room temperature, 2 hours it agitated with same temperature.

Next, it extracted with hexane including water, organic la yer whichis acquired after drying, it removed solvent wit h anhydrous sodium sulfate andacquired crude product.

After refining this with [shirikagerukuromatogurafii] (mo bile layer :hexane /ethylacetate =20/1Rf =0.30), refining furthermore with the high speed liquid chromatography fee (column :Wakosil5Sil20mm X 250mm , eluting liquid :hexane /ethylacetate =20/1), diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (t-butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4-bis it acquired (diphenyl phosphino) butane 30.5mg (0.044 mmol) (yield 69%).

melting point :95~97deg C (Disassembly)

¹H-nmr (CDCl₃);de -ppm :-0.1
7 (s, 6H, SiCH₃), 0.00 (s, 6H, SiCH<sub>3
</sub>), 0.81 (s, 18H, Si- t-Bu), 2.14 (dd, 2H, J=3.2,
13.5Hz , CH₂), 2.55 (dd, 2H, J=1.5, 13.5H
z , CH₂), 3.78 -3.83 (m, 2H, CH), 7.25 7.50 (m, 20H, Ph)

 31 P-NMR(CDCl₃): δ -20.46

マススペクトル:m/e(相対強度)686(M⁺,38), 609 (73), 185(100)

旋光度:[α]_D²⁴-13.4° (c 1.46,CHCl₃)

[0047]

実施例1

アルゴン雰囲気下、4 フッ化ホウ素(1,5-シクロオクタジエン) $_2$ ロジウム 10.2mg と(2R,3R)-2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 17.2mg とを脱気したメタノール 3ml に溶解した後、室温で 15 分間撹拌して、[(1,5-シクロオクタジエン){(2R,3R)-2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン}ロジウム(I)]4 フッ化ホウ素(ロジウム錯体)の溶液を調製した。

また、窒素雰囲気下、2-フェニルイタコン酸 516 mg を脱気したメタノール 5ml に溶解させ、トリエチルアミン $350 \mu l$ を加えた。

この溶液に、先に調整したロジウム錯体の溶液を加え、反応溶液を水素で置換し、室温で24時間撹拌した「H-NMRで反応の完結を確認した後、溶媒を留去した。

残渣に IN NaOH5ml を加え、酢酸エチル 5ml で2回抽出した。

水層に 6N 塩酸を 5ml 加え、水溶液を酸性にした後、析出した白色固体を濾取し、減圧下乾燥することで、2-ベンジルこはく酸 364mg を得た[収率 70%、光学純度 9.7%ee、(S)体]。

[0048]

参考例3

(2R,3R)-2,3-ビス(トリイソプロピルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタンの製造

参考例 1

で得た(2R,3R)-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 1.02g(2.20mmol)とトリエチルアミン 1.4mL(10mmol)とのジクロロメタン 3.4m L 溶液にトリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリル 2.04g(6.6mmol)を室温で加えた ³¹P-nmr (CDCl₃):;de - 20. 46

mass spectrum :m/e (relative intensity) 686 (M \leq sup>+</sup>, 38), 609 (73), 185 (100)

optical rotation: [;al] _D²⁴-13.4* (c1.46, CHCl₃)

[0047]

Working Example 1

Under argon atmosphere , 4 boron fluoride (1 and 5 -cy clooctadiene) ₂rhodium 10.2mg and diisopro pyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis outgassing is done after melting in methanol 3ml which, 15 min agitating (diphenylphosphino) butane 17.2mg w ith room temperature , [(1 and 5 -cyclooctadiene) {diis opropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl sil yl) tartrate 3- bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane } rhodium (I)] itman ufactured solution of 4 boron fluoride (rhodium complex).

In addition, under nitrogen atmosphere, melting 2 -phen yl itaconic acid 516mg in methanol 5ml which the outga ssing is done, it added triethylamine 350;mu l.

reaction solution was substituted with hydrogen including solution of the rhodium complex which in this solution , first was adjusted, after verifying thecompletion of reaction with ¹H-nmr which 24 hours was agita tedwith room temperature , solvent was removed.

In residue twice it extracted with ethylacetate 5ml including 1 NNaOH5ml.

6 Nhydrochloric acid 5 ml were added to water layer, after designating aqueous solution as acidity, white solid which was precipitated was filtered, by thefact that und er vacuum it dries, 2 -benzyl succinic acid 364mg were acquired {yield 70%, optical purity 9.7%ee, S-isomer }.

[0048]

Reference Example 3

diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4 - bis production of(diphenylphosphino) butane

Reference Example 1

So diisopropyl which is acquired (2 R,3R) - 2 and 3 - O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- dihydroxy -1, 4 - bis (diphenylphosphino) butane 1.02g (2.20 mmol) with triethylamine 1.4ml (10 mmol) with after adding silver trifluoromethane sulfonate jp11 Hong acid tri isopropyl silyl 2.04g (6.6 mmol) to dichloromethane 3.4ml soluti

後、同温度下で2時間攪拌した。

その後、水を加え、ヘキサンで抽出して得た有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去し粗生成物を得た。

これをシリカゲルクロマトグラフィー(移動層:へキサン/酢酸エチル=20/1)で精製した後、さらに高速液体クロマトグラフィー(カラム:Wakosil5Sil 20mm×250mm,溶離液:ヘキサン/酢酸エチル=20/1)にて精製し、(2R,3R)-2,3-ビス(トリイソプロピルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 1.53g(1.98mmol)を得た(収率 90%)。

融点:73~75 deg C(分解)

 1 H-NMR(CDCl₃) δ -ppm:0.96(bs,42H,i-Pr), 2.27 (ddd,2H,J=3.0,5.7,13.5Hz,CH₂), 2.71(dd,2H,J=7.0,13.5Hz,CH₂), 4.17-4.30(m,2H,CH), 7.25-7.48 (m,20H,Ph)

³¹P-NMR(CDCl₃): δ -22.06

マススペクトル:m/e(相対強度)770(M⁺,25), 693 (64), 185(100)

旋光度:[α]_D²⁶+63.8° (c 1.57,CHCl₃)

[0049]

実施例2

(2R,3R)-2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 17.2mg に代えて、参考例 2 で得た(2R,3R)-2,3-ビス(トリイソプロピルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 15.0mg を用いた以外は、実施例 1 と同様に操作することによって、[(1,5-シクロオクタジエン){(2R,3R)-2,3-ビス(トリイソプロピルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン}ロジウム(I)]4 フッ化ホウ素の溶液を得、次いで 2-ベンジルこはく酸 423mg を得た〔収率 81%、光学純度 7.6%ee、(S)体〕。

[0050]

参考例4

(2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス (ジフェニルホスフィノ)ブタンの製造 on with room temperature, 2 hours it agitated under sa me temperature.

After that, extracting with hexane including water, organi c layer which it acquires after drying, it removed solvent with anhydrous sodium sulfate and acquired crude product.

After refining this with [shirikagerukuromatogurafii] (mo bile layer :hexane /ethylacetate =20/1), furthermore it re fined with the high speed liquid chromatography fee (col umn :Wakosil5Sil20mm X 250mm , eluting liquid :hexan e /ethylacetate =20/1), diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4-bis acquired (diphenylphosphino) butane 1.53g (1.98 mmol) (yield 90%).

melting point :73~75deg C (Disassembly)

¹H-nmr (CDCl₃);de -ppm :0.96
(bs, 42H, i- Pr), 2.27 (ddd, 2H, J=3.0, 5.7, 13.5Hz ,
CH₂), 2.71 (dd, 2H, J=7.0, 13.5Hz , CH<s
ub>2</sub>), 4.17 - 4.30 (m, 2H, CH), 7.25 - 7.48(m,
20H, Ph)

³¹P-nmr (CDCl₃):;de - 22. 06
mass spectrum :m/e (relative intensity) 770 (M⁺, 25), 693 (64), 185 (100)

optical rotation: [;al] _D²⁶+63.8* (c1.57, CHCl₃)

[0049]

Working Example 2

diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis replacing to (diphenylphosphino) butane 17.2mg, diisopropyl which it acquires with Reference Example 2 (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4 -bis other than using(diphenylphosphino) butane 15.0mg, by fact that it operates in same way as the Working Example 1, [(1 and 5 -cyclooctadiene) {diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (tri isopropyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane } rhodium (I)] you obtained solution of 4 b oron fluoride, 2 -benzyl succinic acid 423mg acquired n ext{yield 81%, optical purity 7.6%ee, S-isomer}.

[0050]

Reference Example 4

diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis production of(diphenylphosphino) butane

参考例 1

で得た(2R,3R)-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 919mg(2.00mmol)とトリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルシリル 2.47g (6.03mmol)とのジクロロメタン溶液(2ml)にトリエチルアミン 1.4mL(10mmol)を室温で加えた後、同温で4時間攪拌した。

その後、水を加え、ジエチルエーテルで抽出し得られた有機層を溶媒留去した後、ヘキサン/酢酸エチル=2/1の混合溶媒を加え、析出した白色沈殿を濾過し、粗生成物を得た。

これを少量の 1,2-ジクロロエタンに溶解し、分取 用 GPC(溶離液 1,2-ジクロロエタン)により分取した後、ヘキサン/酢酸エチル=2/1 の混合溶媒を 用いて再結晶により精製して、(2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン <math>0.30g(0.31mmol)を得た(収率 16%)。

融点:118~119 deg C(分解)

¹H-NMR(CDCl₃) δ -ppm: 2.30(ddd,2H,J=3.0,5. 9,13.5Hz,CH₂), 2.59(dd,2H,J=8.8,13.5Hz,CH₂), 4.24-4.32(m,2H,CH), 6.80-7.53(m,50H,Ph)

 31 P-NMR(CDCl₃): δ -23.51

旋光度:[α]_D²⁴+10.1° (c 1.04,CHCl₃)

[0051]

実施例3

(2R,3R)-2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 17.2mg に代えて、参考例 4 で得た(2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタンを用いる以外は実施例 1 と同様に操作して、 $[(1,5-シクロオクタジェン)\{(2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン<math>\{(2R,3R)-2,3-ビス(x)-2,1\}\}$ ロジウム($\{(2R,3R)-2,3-U\}$)で光学活性 $\{(2R,3R)-2,3-U\}$ でパンジルこはく酸を得る。

[0052]

Reference Example 1

So diisopropyl which is acquired (2 R,3R) - 2 and 3 - O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- dihydroxy -1, 4 - bis (diphenylphosphino) butane 919mg (2.00 mmol) with silver trifluoromethane sulfonate jp11 Hong acid triphenyl silyl 2.47g (6.03 mmol) with after adding triethyl amine 1.4ml (10 mmol) to dichloromethane solution (2 ml) with room temperature, 4 hours it agitated with sa me temperature.

After that, it extracted with diethyl ether including water, it filtered white precipitate which was precipitated solvent removal after doing the organic layer which is acquired, including mixed solvent of hexane /ethylacetate =2/1, ac quired crude product.

This trace it melted in 1 and 2 -dichloroethane, after doing with GPC (eluting liquid 1, 2- dichloroethane) for fraction collection fraction collection, making use of mixed solvent of hexane /ethylacetate =2/1 refining with recrystallization, diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis it acquired (diphenylphosphino) butane 0. 30g (0.31 mmol) (yield 16%).

melting point :118~119deg C (Disassembly)

¹H-nmr (CDCl₃);de -ppm :2.30
(ddd, 2H, J=3.0, 5.9, 13.5Hz , CH₂), 2.59
(dd, 2H, J=8.8, 13.5Hz , CH₂), 4.24 - 4.3
2 (m, 2H, CH), 6.80 - 7.53 (m, 50H, Ph)

³¹P-nmr (CDCl₃):;de - 23. 51

optical rotation : [;al] $\leq D \leq sub \geq 24 \leq sup \geq 10.1*$ (c1.04, CHCl $\leq sub \geq 3 \leq sub \geq 3$

[0051]

Working Example 3

diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (t- butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis replacing to (diphenylphosphino) butane 17.2mg , diisopropyl which it acquires with Reference Example 4 (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) t artrate 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis other than using(diphenylphosphino) butane , operating in same way as Working Example 1, [(1 and 5 -cyclooctadiene) {diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane } rhodium (I)] you ob tain solution of 4 boron fluoride , obtain optically active 2-benzylsuccinic acid succinic acid next.

[0052]

参考例 5

窒素雰囲気下、室温で 6 フッ化アンチモン(1,5-シクロオクタジエン) $_2$ ロジウム 3.9mg(7 μ mol)と (2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス (ジフェニルホスフィノ)ブタン 6.8mg(7 μ mol)をジクロロメタン 0.1mL 中で調整し、10 分間超音波 照射した。

その後、イソプロパノール 0.1mL をゆっくりと加えた。

これを-5 deg C で 2 日間放置して、[(1,5-シ)ロオクタジエン) $\{(2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン}ロジウム(1)]6 フッ化アンチモン塩の単結晶を得た。$

結晶データ:monoclinic space groupP2₁/c(#4);a =11.704(3) Å,b=19.185(4) Å,c=15.019(3) Å, β = 93.88(2), V=3364(1) Å³,Z=2,Dc=1.404gcm⁻³, μ (MoK α)=7.89cm⁻¹,temperature 25 deg C,R=0.034,Rw=0.047,S=1.16;number of unique reflections=6112

[0053]

実施例4

4 フッ化ホウ素(1,5-シクロオクタジエン)₂ ロジウムに代えて 6 フッ化アンチモン(1,5-シクロオクタジエン)₂ ロジウムを用い、(2R,3R)-2,3-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン 17.2mg に代えて(2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタンを用いる以外は、実施例 1 と同様に操作して、[(1,5-シクロオクタジエン){(2R,3R)-2,3-ビス(トリフェニルシロキシ)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン}ロジウム(1)]6 フッ化アンチモンの溶液を得、次いで光学活性 2-ベンジルこはく酸を得る。

Reference Example 5

Under nitrogen atmosphere, with room temperature 6 an timony fluoride (1 and 5 -cyclooctadiene) ₂rhodium 3.9mg (7;mu mol) with disopropyl (2 R,3R) 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3-bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis you adjusted (diphenyl phosphino) butane 6.8mg (7;mu mol) in dichloromethane 0.1 ml, 10 min ultrasound irradiation did.

After that, isopropanol 0.1 ml was added slowly.

- 2 day leaving this with 5 deg C, [(1 and 5 -cyclooct adiene) {diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-buty l dimethyl silyl) tartrate 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 a nd 4 -bis (diphenylphosphino) butane } rhodium (l)] it acquired single crystal of 6 antimony fluoride salt .

crystal data :monoclinicspacegroupP2₁/c (# 4); a=11.704 (3) \$, b=19.185 (4) \$ and c=15.019 (3) \$,; be = 93.88 (2), V=3364 (1) \$³, Z=2, Dc=1. 404gcm⁻³, ;mu (MoK;al) = 7.89 cm ⁻¹, temperature25deg C, R=0.034, Rw=0.047, S=1.1 6;numberofuniquereflections=6112

[0053]

Working Example 4

Replacing to 4 boron fluoride (1 and 5 -cyclooctadiene) ₂rhodium, diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (t-butyl dimethyl siloxy) - 1 and 4 -bis replacing to (diphenylph osphino) butane 17.2mg making use of 6 antimony fluoride (1 and 5 -cyclooctadiene) ₂rhodium, diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis ot her than using (diphenylphosphino) butane, operating in same way as Working Example 1, [(1 and 5 -cyclooct adiene) {diisopropyl (2 R,3R) - 2 and 3 -O-bis (t-butyl dimethyl silyl) tartrate 3- bis (triphenyl siloxy) - 1 and 4 -bis (diphenylphosphino) butane} rhodium (I)] you obtain solution of 6 antimony fluoride, obtain optic ally active 2-benzylsuccinic acid succinic acid next.